# WH<sup>®</sup>

# CH32M030数据手册

V1.1

## 概述

CH32M030系列是基于青稞RISC-V3B内核设计的工业级电机微控制器。CH32M030内置4个0PA运放和3个电压比较器CMP,支持组合成2组交流小信号放大解码器QII和2组差分输入电流采样ISP;内置USB PHY和PD PHY,支持USB Host主机和USB Device设备功能、PDUSB、Type-C快充功能、BC1.2及DCP/CDP等多种高压充电协议;内置4对N型功率管栅极预驱,提供高压I/0;内置可编程灌电流模块;提供DMA控制器、12位模数转换ADC、多组定时器、UART串口、I2C、SPI等外设资源,提供过压保护和过温保护。

## 产品特性

#### ● 内核Core

- 青稞32位RISC-V3B内核
- 支持RV32IMCB指令集和自扩展指令
- 三级流水线
- 特有高速的中断响应机制
- 最高72MHz系统主频

#### ● 存储器

- 12KB易失数据存储区SRAM
- 64KB带ECC程序存储区Code Flash
- 512B用户自定义信息存储区

#### ● 电源管理和低功耗

- 内置高压LDO, V<sub>m</sub>支持额定5~28V系统供电
- 预驱动I/0供电V∞额定电压: 5~10V
- 普通I/O和ADC供电Vpp33额定电压: 3.3V
- 低功耗模式: 睡眠、停止、待机

## ● 4个双N型MOSFET半桥驱动器

- 4对高侧/低侧MV引脚. 支持Vps.电压
- 内置低压降自举二极管, 外部只需要电容
- 可组合为三相电机栅极驱动
- 可组合为两路独立的全桥驱动

#### ● 系统时钟

- 内置出厂调校的8MHz的RC振荡器
- 内置约340kHz的RC振荡器
- 支持外部4~25MHz晶体

#### ● 7路通用DMA控制器

- 7个通道。支持环形缓冲区管理
- 支持TIMx/ADC/UART/I2C/SPI

#### ● 12位模数转换ADC

- 模拟输入范围: GND~V<sub>DD33</sub>
- 20路外部信号通道
- 支持外部延迟触发,支持ADC滑动平均功能
- 0TP过温保护和0VP过压保护及欠压复位
- 多引脚映射的UART串口

#### ● 120接口

- SPI接口
- 2组Type-C和USB PD控制器及PHY
- 支持DRP、Sink和Source应用
- 4个耐高压的CC引脚

## ● 全速USB 2.0控制器及PHY

- 支持PDUSB、Host主机和Device设备模式
- 支持BC1.2及多种HV DCP/CDP充电协议
- 内置6位DAC, 可编程电压输出及上下拉

#### ● 多组定时器

- 1个16位高级定时器,提供死区控制和紧急刹车,提供用于电机控制的PWM互补输出
- 1个16位通用定时器
- 1个16位的精简诵用定时器
- 1个窗口看门狗定时器
- 系统时基定时器: 32位计数器

#### ● 4个运放OPA和3个模拟电压比较器CMP

- 可组合为2组交流小信号放大解码器QII1及QII2和2组差分输入电流采样ISP1及ISP2
- 0PA1和0PA2支持自偏置的PGA
- 0PA3和0PA4支持单端及差分输入, PGA多档增 益选择,提供内部自偏置电压
- CMP1支持数字滤波
- CMP2和CMP3支持N端偏置可选,数字滤波
- CMP3有多路输入通道,输出到1/0或者内部
- 2组10位可编程灌申流模块
- 2组源电流模块
- GPIO端口
- 36个1/0口,映射16个外部中断
- 8个MV预驱动引脚, 2个HV高压引脚
- 安全特性: 64位芯片唯一ID
- 调试模式:支持单线和双线两种调试模式
- 封装形式: LQFP、QFN、QSOP

<b>一</b> 资》	原	型号	C8U3	C8T7	C8U7	K8U7	G8R7
	芯片	引脚数	48	48	48	32	28
C	ode Flas	sh(字节)	64K	64K	64K	64K	64K
	SRAM (	(字节)	12K	12K	12K	12K	12K
	半桥栅极驱动器		4	4	4	2	3
	通用1/0		36	35	36	24	17
预	郧劲I/0	(MV I/O)	8	8	8	6	6
	高压1/0	(HV I/O)	2	-	1	1	-
	高级TI	M1(16位)	1	1	1	1	1
定	通用TI	M2(16位)	1	1	1	1	1
时	精简TI	M3(16位)	1	1	1	1	1
器	窗口看ì	门狗(WWDG)	1	1	1	1	1
	系统时	基(32位)			√		
	Al	DC	20	20	20	16	11
	OF	PA1	1	1	1	_	-
	OF	PA2	1	1	1	1	1
	OF	PA3	1	1	1	1	1
	OF	PA4	1	1	1	1	1
	CM	IP1	1	1	1	_	-
	CM	IP2	1	1	1	1	1
	CM	IP3	1	1	1	1	1
	电流采样	∮ISP, ISN	差分*2	差分*2	差分*2	差分*1 单端*1	差分*2
	信号解	₽码QII	2	2	2	1	1
可	编程灌电	流模块ISINK	2	2	2	2	1
	源电流模	块ISOURCE	2	2	2	1	-
		UART	1	1	1	1	1
		SPI	1	1	1	1	-
通		120	1	1	1	1	1
信		USBFS	Host	Host	Host	Host	Host
接		USDES	Device	Device	Device	Device	Device
	PDUSB	USB PD	(CC1R, CC2R)	(CC1, CC2)	(CC1R, CC2R)	(CC1R, CC2R)	
		Type-C	(CC3, CC4)	(CC3, CC4)	(CC3, CC4)	(CC3, CC4)	(CC3, CC4)
			内置Rd <sup>⑴</sup>		内置Rd <sup>⑴</sup>	内置Rd <sup>⑴</sup>	
	封装	形式	QFN48X7_A	LQFP48	QFN48	QFN32	QSOP28

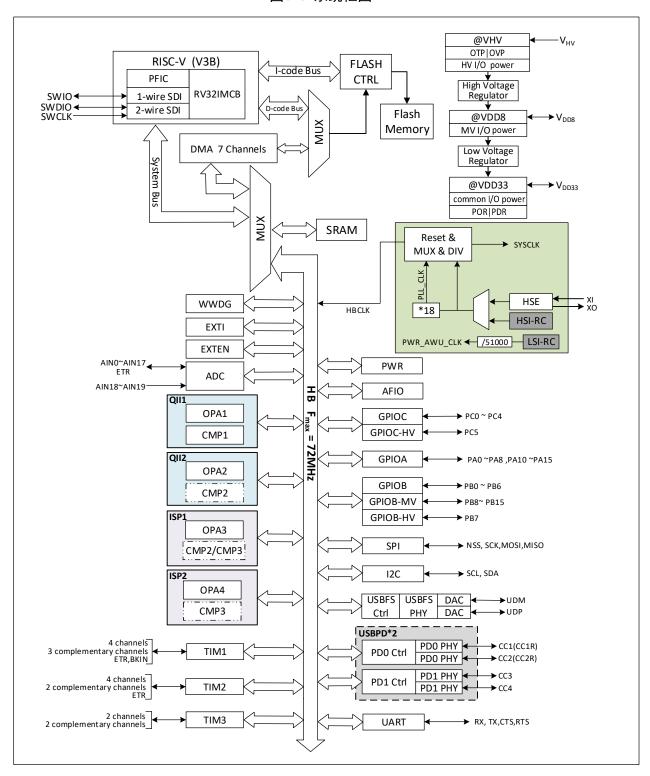
注:1. 引脚PAO/CC1R和PA1/CC2R内置Type-C规范定义的可控Rd下拉电阻,约5. 1kΩ。

## 第1章 规格信息

## 1.1 系统架构

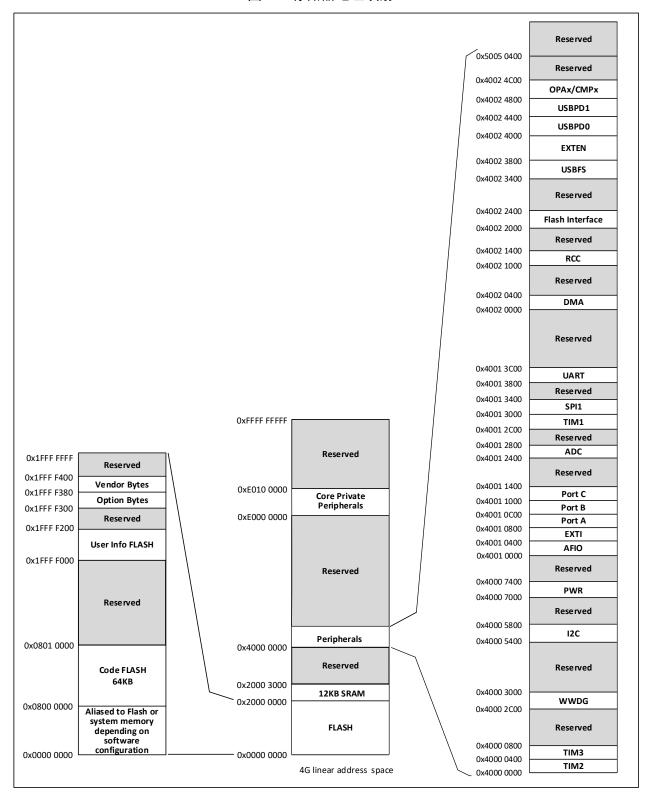
微控制器基于RISC-V指令集的青稞V3B设计,其架构中将内核、仲裁单元、DMA模块、SRAM存储等部分通过多组总线实现交互。设计中集成通用DMA控制器以减轻CPU负担、提高访问效率,同时兼有数据保护机制,时钟自动切换保护等措施增加了系统稳定性。下图是CH32M030内部总体架构框图。

图1-1 系统框图



## 1.2 存储器映射表

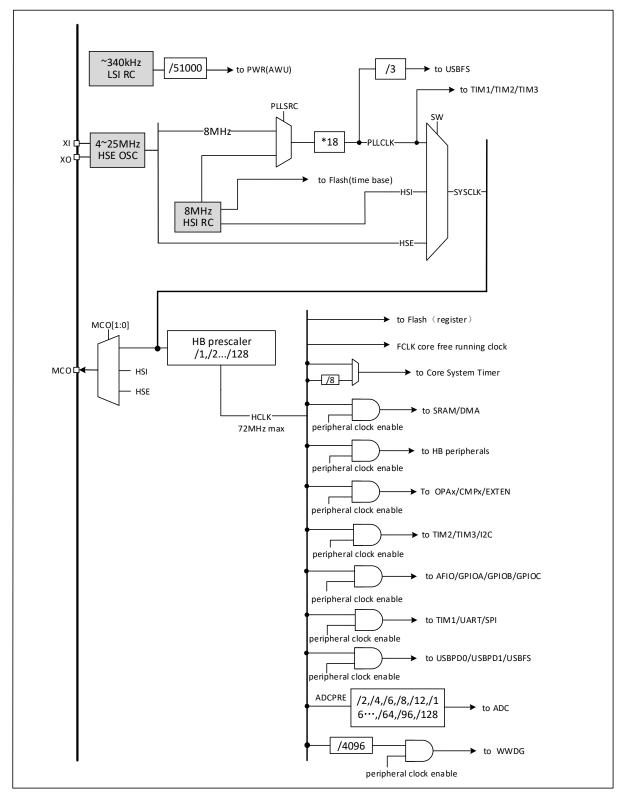
图1-2 存储器地址映射



## 1.3 时钟树

系统中引入3组时钟源:内部高频RC振荡器(HSI)、内部低频RC振荡器(LSI)和外部高频振荡器(HSE)。其中,低频时钟源为自动唤醒单元提供了时钟基准,高频时钟源直接或者间接通过18倍频后输出为系统总线时钟(SYSCLK),系统时钟再由各预分频器提供了HB域外设控制时钟及采样或接口输出时钟。

图1-3 时钟树框图



#### 1.4 功能概述

#### 1.4.1 青稞RISC-V3B处理器

RISC-V3B是32位嵌入式处理器。处理器内部以模块化管理,支持RISC-V标准指令集IMCB子集。包含快速可编程中断控制器(PFIC)、扩展指令支持等单元。对外多组总线与外部单元模块相连,实现外部功能模块和内核的交互。

青稞处理器以其极简指令集、多种工作模式、模块化定制扩展等特点可以灵活应用不同场景MCU设计,例如小面积低功耗嵌入式场景等。

- 支持机器和用户特权模式
- 快速可编程中断控制器 (PFIC)
- 2级硬件中断堆栈
- 支持串行单/双线调试接口
- 自定义扩展指令

#### 1.4.2 片上存储器

内置12K字节SRAM区,用于存放数据,掉电后数据丢失。

内置64K字节程序闪存存储区(Code FLASH),即用户区,带ECC校验,用于用户的应用程序和常量数据存储。

内置512字节用户自定义信息存储区(User Info FLASH),仅可用WCH-LinkUtility软件工具操作。 内置128字节系统非易失配置信息存储区,用于厂商配置字存储,出厂前固化,用户不可修改。 内置128字节用户选择字存储区。

#### 1.4.3 供电方案

CH32M030内置了3级LD0调压器,分别是从V<sub>W</sub>产生V<sub>008</sub>的高压调压器、从V<sub>008</sub>产生V<sub>0033</sub>的低压调压器、从V<sub>0033</sub>产生内核电源的内核调压器。

 $V_{HV}$  = 4.0~29.0V:为内部高压调压器和HV高压I/0引脚供电,建议 $V_{HV}$ 上累计电容量不小于10uF。  $V_{DDS}$  = 4.0~10.5V:内部高压调压器在 $V_{DDS}$ 引脚产生电压,为MV预驱动I/0引脚供电和内部低压调压器供电。建议 $V_{DDS}$ 外接10uF退耦电容;在不启用电机预驱时,外接电容可以减小。

 $V_{DD33} = 3.1 \sim 3.5 V$ : 内部低压调压器在 $V_{DD33}$ 引脚产生额定3.3 V电压,为普通I/O引脚和ADC以及内核调压器供电。建议 $V_{DD33}$ 外接 $1 U F \sim 10 U F$ 容量的电容。

在高压下工作时,CH32M030内部LD0累计功耗较大,为了降低芯片温度,外部可选直接向V₀∞供电5.0~10.0V,此时要求V₀∞≤Vну;外部可选直接向V₀∞3供电3.3V,此时要求V₀∞≤≤Vну。

#### 1.4.4 保护和复位电路

CH32M030内部集成了上电复位 (POR) /掉电复位 (PDR) 电路,当V<sub>DD3</sub>电压高于设定的阈值 (V<sub>POR/PDR</sub>) 后,系统开始工作;当V<sub>HV</sub>电压下降到使V<sub>DD3</sub>电压低于设定的阈值 (V<sub>POR/PDR</sub>) 时,置系统于复位状态,而不必使用外部的欠压复位电路。关于V<sub>POR/PDR</sub>的值参考表3-4。

CH32M030内置了OTP过温保护,在芯片温度过高时将强行复位MCU。

CH32M030的PB4引脚支持ADC和0VP过压复位,可以将V<sub>IV</sub>通过片外两个电阻分压后连接到PB4自主配置0VP过压保护,一是可以通过ADC得到实时的V<sub>IV</sub>值;二是自主设置V<sub>IV</sub>的过压保护点,当PB4引脚电压超过0VP过压复位阈值电压(V<sub>OVP\_REF</sub>)时,置系统于复位状态。例如:上电阻200K和下电阻15K将得到约21.5V的过压复位电压。关于V<sub>OVP\_REF</sub>的值参考表3-4。

#### 1.4.5 系统电压调节器LD0

复位后,调节器自动开启,根据应用方式有两种操作模式:

● 开启模式:正常的运行操作,提供稳定的内核电源。

● 低功耗模式: 当芯片进入待机模式后, 调节器低功耗运行。

#### 1.4.6 快速可编程中断控制器 (PFIC)

青稞内核MCU内置快速可编程中断控制器 (PFIC),最多支持255个中断向量,以最小的中断延迟提供了灵活的中断管理功能。CH32M030管理了5个内核私有中断和31个外设中断管理,其他中断源保留。

- 提供5个不可屏蔽中断
- 支持2级中断嵌套进入和退出硬件自动压栈和恢复,无需指令开销
- 提供4路可编程快速中断通道, 自定义中断向量地址
- 31个外设中断,每个中断请求都有独立的触发和屏蔽位、状态位

#### 1.4.7 低功耗模式

系统支持三种低功耗模式,可以针对低功耗、短启动时间和多种唤醒事件等条件下选择达到最佳的平衡。

#### ● 睡眠模式(SLEEP)

在睡眠模式下,只有CPU时钟停止,但所有外设时钟供电正常,外设处于工作状态。此模式是最浅低功耗模式,但可以达到最快唤醒。

退出条件:任意中断或唤醒事件。

#### ● 停止模式(STOP)

此模式下,高频时钟(HSE/HSI/PLL)域被关闭,SRAM和寄存器内容保持,I/0引脚状态保持。该模式唤醒后系统可以继续运行,此时HSI作为默认系统时钟源。

退出条件:任意外部中断/事件。

#### ● 待机模式 (STANDBY)

置位PDDS、SLEEPDEEP位,执行WFI/WFE指令进入。此模式下,高频时钟(HSE/HSI/PLL)域被关闭,SRAM和寄存器内容保持,I/0引脚状态保持,可以达到最低的电能消耗。该模式唤醒后系统可以继续运行,此时HSI作为默认系统时钟源。待机模式对比停止模式,唯一的差别在于: 待机模式下,系统电压调节器将进入低功耗模式。

退出条件:任意外部中断/事件(EXTI信号)、RST上的外部复位信号,其中EXTI信号包括36个外部 I/0口(PAO~PA8, PA10~PA15, PBO~PB6, PB8~PB15, PCO~PC5)之一,自动唤醒信号,USB的唤醒信号,USB PD唤醒信号等。

#### 1.4.8 外部中断/事件控制器(EXTI)

外部中断/事件控制器总共包含20个边沿检测器,用于产生中断/事件请求。每个中断线都可以独立地配置其触发事件(上升沿或下降沿或双边沿),并能够单独地被屏蔽;挂起寄存器维持所有中断请求状态。EXTI可以检测到脉冲宽度小于内部HB的时钟周期。36个通用I/0口都可选择连接对应的16个外部中断源。

#### 1.4.9 通用DMA控制器

系统内置了1组通用DMA控制器,管理7个通道,灵活处理存储器到存储器、外设到存储器和存储器到外设间的高速数据传输,支持环形缓冲区方式。每个通道都有专门的硬件DMA请求逻辑,支持一个或多个外设对存储器的访问请求,可配置访问优先权、传输长度、传输的源地址和目标地址等。

DMA用于主要的外设包括:定时器TIMx、ADC、UART、I2C、SPI。

注: DMA和CPU经过仲裁器仲裁之后对系统SRAM进行访问。

#### 1.4.10 时钟和启动

系统时钟源HSI默认开启,在没有配置时钟或者复位后,内部8MHz时钟作为默认的CPU时钟,随后可以另外选择外部4~25MHz时钟或PLL时钟。对于关闭时钟的低功耗模式,唤醒后系统也将使用内部的

RC振荡器。如果使能了时钟中断,软件可以接收到相应的中断。

#### 1.4.11 ADC (模拟/数字转换器)

CH32M030内置1个12位的模拟/数字转换器(ADC),支持多达20个外部通道,可编程的通道采样时间,可以实现单次、连续、扫描或间断转换。提供模拟看门狗功能允许非常精准地监控一路或多路选中的通道,用于监测通道信号电压,监测到电压超过设定的阈值时,可配置产生复位,保护系统。

支持外部事件触发转换,触发源包括片上定时器的内部信号和外部引脚。支持使用DMA操作以及ADC滑动平均功能。

ADC\_IN9、ADC\_IN10、ADC\_IN18以及ADC\_IN19可复用为内部通道,连接OPA的输出端,寄存器配置 请参考CH32M030RM手册的17.2章节。

#### 1.4.12 定时器及看门狗

系统中的定时器包括1个高级定时器、1个通用定时器、1个精简定时器、1个看门狗定时器以及系统时基定时器。

#### ● 高级定时器(TIM1)

高级定时器是一个16位的自动装载递加/递减计数器,具有16位可编程的预分频器。除了完整的通用定时器功能外,可以被看成是分配到6个通道的三相PWM发生器,具有带死区插入的互补PWM输出功能,允许在指定数目的计数器周期之后更新定时器进行重复计数周期,刹车功能等。高级定时器的很多功能都与通用定时器相同,内部结构也相同,因此高级定时器可以通过定时器链接功能与其他TIM定时器协同操作,提供同步或事件链接功能。

#### ● 通用定时器(TIM2)

通用定时器是一个16位的自动装载递加/递减计数器,具有一个可编程的16位预分频器以及4个独立的通道,每个独立通道都支持输入捕获、输出比较、PWM生成和单脉冲模式输出。通过复用通道3和4,通道1和2还具有带死区插入的互补PWM输出功能。

#### ● 精简定时器(TIM3)

精简定时器是一个16位的自动装载递加/递减计数器,具有一个可编程的16位预分频器以及2个独立的通道,每个独立通道都支持输入捕获、输出比较、PWM生成和单脉冲模式输出,同时还带有简单的死区控制。

#### ● 窗口看门狗(WWDG)

窗口看门狗是一个7位的递减计数器,并可以设置成自由运行。可以被用于在发生问题时复位整个系统。其由主时钟驱动,具有早期预警中断功能;在调试模式下,计数器可以被冻结。

#### ● 系统时基定时器(SysTick)

青稞微处理器内核自带一个32位递增的计数器,用于产生SYSTICK异常,可专用于实时操作系统, 为系统提供"心跳"节律,也可当成一个标准的32位计数器。具有自动重加载功能及可编程的时钟源。

#### 1.4.13 通用异步收发器(UART)

CH32M030提供了1组通用异步收发器(UART)。支持全双工异步通信以及半双工单线通信,也支持LIN(局部互连网),兼容IrDA SIR ENDEC传输编解码规范和调制解调器(CTS/RTS硬件流控)操作,还允许多处理器通信。其采用分数波特率发生器系统,并支持DMA操作连续通讯。

#### 1.4.14 I2C总线

1个I2C总线接口,能够工作于多主机模式或从机模式,完成所有I2C总线特定的时序、协议、仲裁等,支持标准和快速两种通讯速度。

I20接口提供7位或10位寻址,并且在7位从模式时支持双从地址寻址。内置了硬件CRC发生器/校验器。

#### 1.4.15 串行外设接口(SPI)

芯片提供1个串行外设SPI接口,支持主或从操作,动态切换。支持多主模式,全双工或半双工同步传输,支持基本的SD卡和MMC模式。可编程的时钟极性和相位,数据位宽提供8或16位选择,可靠通信的硬件CRC产生/校验,支持DMA操作连续通讯。

#### 1.4.16 Type-C及USB PD控制器

内置两组USB Power Delivery控制器和PD收发器PHY,提供4个耐高压的CC引脚PAO/PA1/PA2/PA3。PAO和PA1为一对CC引脚,连接到一个PD控制器;PA2和PA3为一对CC引脚,连接到另一个PD控制器。CC1/CC2/CC3/CC4如果有后缀R则表示内置Type-C规范定义的可控Rd下拉电阻,默认开启。

内置多级上拉电流,支持USB Type-C主从检测,自动BMC编解码和CRC,硬件边沿控制,支持USB PD2.0 和PD3.0电力传输控制,支持快充,支持UFP/PD受电端Sink和DFP/PD供电端Source应用、DRP应用以及动态切换,与可编程灌电流模块ISINK配合可支持PPS高精度调压。

#### 1.4.17 通用串行总线USB 2.0全速主机/设备控制器(USBFS)

USB 2.0全速主机控制器和设备控制器(USBFS),遵循USB 2.0 Fullspeed标准,支持PDUSB。提供16个可配置的USB设备端点及一组主机端点。支持控制/批量/同步/中断传输,双缓冲区机制,USB总线挂起/恢复操作,并提供待机/唤醒功能。此外,还内置6位DAC、输出缓冲器和输出比较器。

- 支持USB Host主机功能和USB Device设备功能
- 支持USB 2.0全速12Mbps或者低速1.5Mbps
- 支持USB控制传输、批量传输、中断传输、同步/实时传输
- 支持最大64字节的数据包,内置FIFO,支持中断和DMA
- 支持BC1.2及DCP/CDP等多种高压充电协议
- 内置6位DAC及输出缓冲器,支持输入比较
- 支持可编程电压输出、可编程上拉和下拉电阻

#### 1.4.18 OPA与CMP特性

CH32M030芯片内置4个0PA运放(0PA1、0PA2、0PA3、0PA4)和3个CMP电压比较器(CMP1、CMP2、CMP3),支持有感定位、ADC采样无感定位、比较器无感定位,单电阻或双电阻电流采样方案。

OPA1、OPA2支持自偏置的可编程增益运放(PGA)。其中,OPA1的输出结果在芯片内部连接至电压比较器CMP1和ADC通道IN19;OPA2的输出结果在芯片内部连接至电压比较器CMP2和ADC通道IN18。

OPA3、OPA4支持单端及差分输入,可通过更改配置进行PGA放大倍数选择,还提供内部自偏置电压。 其中,OPA3的输出结果在芯片内部连接至电压比较器CMP2或CMP3,以及ADC通道IN9;OPA4的输出结果 在芯片内部连接至电压比较器CMP3,以及ADC通道IN10。

CMP1支持可选迟滞特性,支持输出端数字滤波功能,且输出滤波可选。

CMP2支持可选迟滞特性,支持内部N端偏置可选以及输出端数字滤波功能。其P端通道可由GP10输入或者在芯片内部与OPA运放连接;其N端通道可由GP10输入或者在芯片内部与DAC输出连接。

CMP3支持可选迟滞特性,支持内部N端偏置可选,以及输出端数字滤波功能。其P端通道可由GPIO输入或者在芯片内部与OPA运放连接;其N端通道由GPIO输入;其电压比较结果OUT0由GPIO模拟输出,OUT1和OUT2通过GPIO口推挽输出。此外,在芯片内部,CMP3的输出通道连接到TIM2的四个通道,用于捕获触发,还连接到TIM1的BKIN通道,作为TIM1的刹车源,实现过流保护。

这些OPA和CMP可支持组合为2组交流小信号放大解码器(QIII和QII2)和2组差分输入电流采样(ISP1和ISP2)。

## 1.4.18.1 交流小信号放大解码器(QII)

芯片支持2组交流小信号放大解码器QII1和QII2。其中,QII1由1个前级的可调增益放大器OPA1、1个后级的电压比较器CMP1、数字滤波器组成;而QII2由1个前级的可调增益放大器OPA2、1个后级复用的电压比较器CMP2、数字滤波器组成。

输入的交流小信号通过0PA进行放大,并使用电压比较器整形为数字信号,经数字滤波器进行滤波 后解码,可实现传输过程中的高质量与低误码率。也可以将放大后的信号送入ADC进行解码。

- QII1和QII2输出通道直连到ADC内部通道或比较器CMP输入端
- QII1和QII2支持PGA自偏置以及PGA多种增益可选,支持数字滤波
- Q112中的比较器CMP2的N端支持可选的内部自偏置电压

#### 1.4.18.2 差分输入电流采样(ISP)

CH32M030支持2组差分输入的电流采样ISP1和ISP2,支持双电阻电流采样和过流保护。其中,ISP1由1个前级的可调增益放大器0PA3、1个后级复用的电压比较器CMP2或CMP3组成;ISP2由1个前级的可调增益放大器0PA4、1个后级复用的电压比较器CMP3组成。

ISP1和ISP2支持差分或单端应用。当差分应用时, ISP1和ISN1/PA8引脚为一对差分输入, ISP2/PA10和ISN2/PA11引脚为另一对差分输入; 而当单端应用时, 无需负端输入ISN, 此时ISN1/PA8和ISN2/PA11引脚可用于任何用途, 例如ADC或者GP10。

ISP通过外部电阻采集电流得到弱电压信号,经闭环放大器OPA放大后,结果送入ADC或比较器。

- ISP1和ISP2支持差分或单端输入,增益及输出直流电平可配置
- ISP1和ISP2输出通道直连到ADC内部通道或比较器CMP输入端

#### 1.4.19 可编程灌电流模块ISINK/源电流模块ISOURCE

系统提供了2组可编程灌电流模块ISINK和2组源电流模块ISOURCE。

可编程灌电流模块ISINK支持10位电流精度,可用于以20mV为步距对外部DC-DC进行高精度电压调节,实现PPS协议。

源电流模块可用于外接低成本的NTC感温电阻等,通过ADC计算温度。

#### 1.4.20 栅极驱动器

CH32M030集成了4个独立半桥驱动器,每个半桥均包含低压降的自举二极管、高侧和低侧电平移位电路、高侧和低侧输出驱动电路,支持4对N型MOSFET功率管的栅极驱动,外部仅需一个电容保存自举电源,栅极驱动电压取决于V<sub>008</sub>,从5V到10V共4档可调。

4个独立半桥可组成三相半桥,用于三相电机的栅极驱动,由TIM1产生的PB8~PB13信号控制;4 个独立半桥也可组成2组全桥,用于两路独立的全桥驱动,分别由TIM1产生的PB8~PB11信号和TIM2产 生的PB12~PB15信号控制。定时器产生PWM信号,支持死区时间控制,支持过流保护刹车控制。

下图1-4为单个半桥驱动器的结构框图。

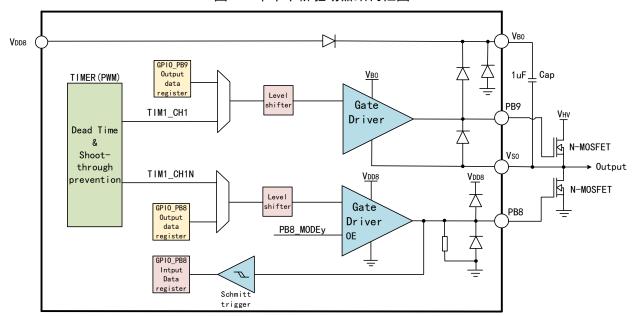


图1-4 单个半桥驱动器结构框图

注: Cap为片外电容; N-MOSFET为片外N型MOSFET功率管。

#### 1.4.21 通用输入输出接口(GPIO)

系统提供了3组GPI0端口,共37个GPI0引脚(PA0~PA8, PA10~PA15, PB0~PB15, PC0~PC5)。所有的GPI0引脚可以由软件配置成输出(推挽或开漏),除PB7、PB9、PB11、PB13、PB15以外的GPI0引脚可以由配置成输入或复用的外设功能端口。多数GPI0引脚都与数字或模拟的复用外设共用,提供锁定机制冻结10配置,以避免意外的写入I/0寄存器。

PB8~PB15为V∞,供电的预驱动MV I/0引脚,PB7为高压开漏输出引脚,PC5为V√供电的高压HV I/0引脚,其余为V∞,供电的普通I/0引脚。

PB9、PB11、PB13、PB15为推挽输出,默认输出低电平,不支持输入。

PB7仅支持高压开漏输出,不支持输入; PC5支持轻载下的推挽输出,在压差7V以下可防电流倒灌。除PB7~PB15以及PC5外,所有GP10引脚都支持可控上拉,其中,CC1/CC2/CC3/CC4提供的是多级上拉电流。

PBO和PB1内置默认开启、可以调节、可以关闭的下拉电阻,由EXTEN\_CTLR1中的两组PDE和DAC进行调节和控制,并可提供下拉电流;CC1/CC2/CC3/CC4如果有后缀R则表示内置Type-C规范定义的可控Rd下拉电阻,默认开启;PAO/CC1R和PA1/CC2R引脚内置可控Rd下拉电阻,作为GPIO推挽输出时建议关闭下拉;PB8、PB10、PB12、PB14内置不可关闭的下拉电阻;除此之外的GPIO引脚均未内置下拉电阻。

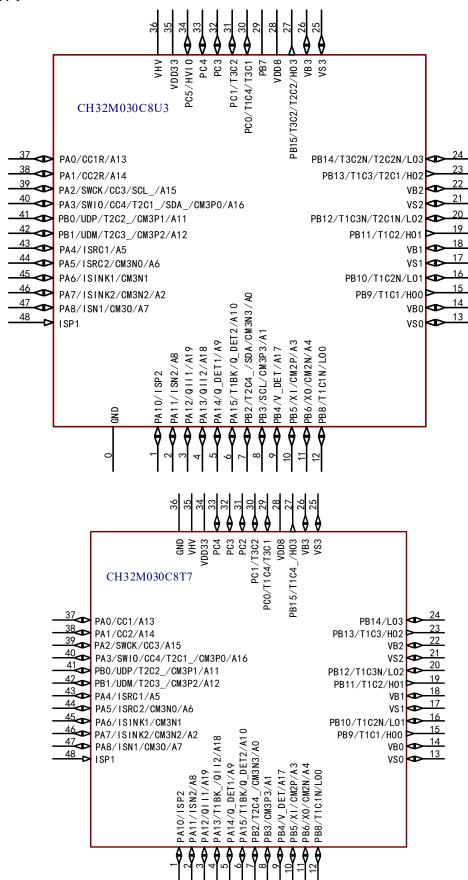
MV I/0引脚(PB8~PB15)由V<sub>008</sub>提供电源,通过改变V<sub>008</sub>供电将改变MV引脚输出电平高值来适配外部接口电平。其中,PB9、PB11、PB13、PB15供电为基于V<sub>008</sub>供电的自举电源,输出高电平时为V<sub>8</sub>,输出低电平时为V<sub>8</sub>。HV I/0引脚PC5由V<sub>HV</sub>提供电源,通过改变V<sub>HV</sub>供电将改变HV I/0引脚输出电平高值来适配外部接口电平。普通I/0引脚由V<sub>0033</sub>提供电源,通过改变V<sub>0033</sub>供电将改变普通I/0引脚输出电平高值来适配外部接口电平。具体引脚请参考第二章引脚描述。

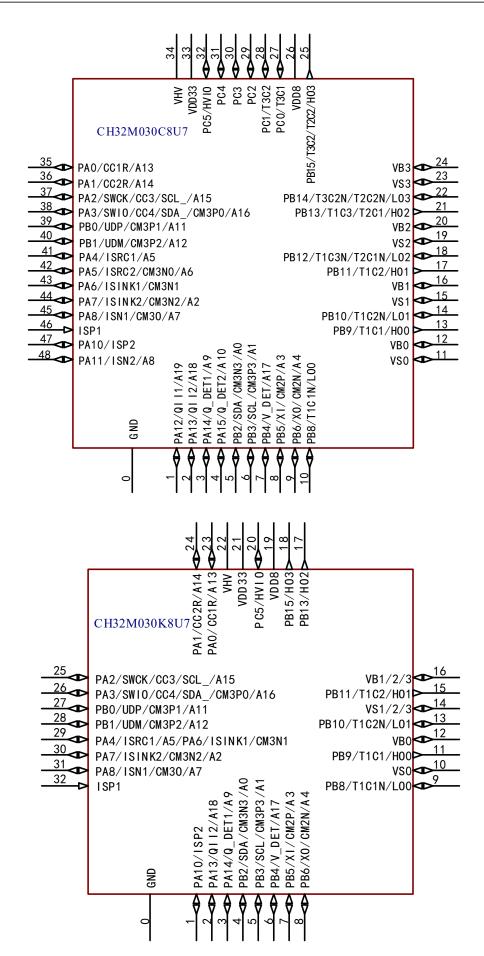
#### 1.4.22 调试接口(SDI Serial Debug Interface)

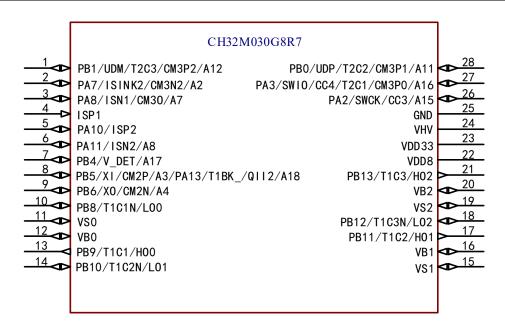
内核自带一个串行单线调试接口(1-wire SDI Serial Debug Interface)和一个串行2线调试接口(2-wire SDI Serial Debug Interface)。系统支持单双线两种调试模式;其中,单线调试为默认调试模式,对应SWIO引脚,而双线调试对应SWDIO和SWCLK引脚,可以提高下载速度。系统上电或复位后默认调试接口引脚功能开启,主程序运行后可以根据需要关闭调试引脚复用功能。

## 第2章 引脚信息

## 2.1 引脚排列







#### 注: 引脚图中复用功能均为缩写。

示例: A:ADC\_(A13:ADC\_IN13)

T:TIM\_(T2C4:TIM2\_CH4, T1C1N:TIM1\_CH1N, T1BK:TIM1\_BKIN)

CM3:CMP3\_(CM3P2:CMP3\_P2, CM3N2:CMP3\_N2)
CM2:CMP2\_(CM2P:CMP2\_P, CM2N:CMP2\_N)

SWCK:SWCLK SWIO:SWDIO ISRC:ISOURCE

# 2.2 引脚定义

注意,下表中的引脚功能描述针对的是所有功能,不涉及具体型号芯片。不同型号之间外设资源有差异,查看前请先根据芯片型号资源表确认是否有此功能。

表2-1 引脚定义

	引脚编号									
qS0P28	QFN32	QFN48	QFN48X7_A	LQFP48	引脚 名称	引脚 类型 (1)	I/0 特性 ⑴ ⑶	主功能(复位后)	默认复用功能	重映射功能 <sup>⑵</sup>
_	0	0	0	_	GND	Р	_	GND		
5	1	47	1	1	PA10	1/0/A	_	PA10	ISP2	
6	_	48	2	2	PA11	1/0/A	_	PA11	ADC_IN8/ISN2	SPI_MOSI_2
_	_	1	3	3	PA12	1/0/A	_	PA12	ADC_IN19/QII1	
8	2	2	4	4	PA13 <sup>(7)</sup>	1/0/A	_	PA13	ADC_IN18/QII2	TIM1_BKIN_1
-	3	3	5	5	PA14	1/0/A	_	PA14	ADC_IN9/ADC_ETR/ UART_CTS/Q_DET1	UART_CTS_1/I2C_SDA_2
-	-	4	6	6	PA15	1/0/A	-	PA15	ADC_IN10/TIM1_BKIN /UART_RTS/RST (4) /Q_DET2	TIM1_BKIN_2/TIM1_BKIN_3/ TIM1_BKIN_4/UART_RTS_1/ I2C_SCL_2
_	4	5	7	7	PB2	1/0/A	_	PB2	ADC_INO/TIM3_CH1N/ I2C_SDA/CMP3_N3	TIM2_CH4_1/TIM2_CH4_3/ TIM2_CH2N_1/TIM2_CH2N_3/ TIM3_CH1_ETR_2/ TIM3_CH2_1/UART_CTS_3/ UART_CTS_4/UART_CTS_5
-	5	6	8	8	PB3	I/0/A	-	PB3	ADC_IN1/TIM3_CH2N/ I2C_SCL/CMP3_P3	TIM3_CH2_2/TIM3_CH2N_1/ UART_RTS_3/UART_RTS_4/ UART_RTS_5
7	6	7	9	9	PB4 (11)	1/0/A	-	PB4	ADC_IN17/CMP3_OUT1 /V_DET	TIM3_CH1N_2
8	7	8	10	10	PB5 <sup>(7)</sup>	1/0/A	-	PB5	ADC_IN3/XI/ CMP3_OUT2/CMP2_PO	TIM3_CH2N_2/TIM3_CH2_3/ TIM2_CH1_ETR_3/ UART_RX_2/SPI_MOSI_1
9	8	9	11	11	PB6	I/0/A	-	PB6	ADC_IN4/X0/CMP2_N0	ADC_ETR_1/TIM2_CH2_3/ TIM3_CH2N_3/UART_TX_2/ I2C_SDA_1/SPI_SCK_1
10	9	10	12	12	PB8	1/0	MV/PD	PB8	LOO/TIM1_CH1N	TIM1_CH1N_1/TIM1_CH1N_2/ TIM1_CH1N_4
11	10	11	13	13	V <sub>so</sub>	Р	-	V <sub>so</sub>		
12	12	12	14	14	V <sub>BO</sub>	Р	-	$V_{B0}$		
13	11	13	15	15	PB9	0	MVO	PB9	HOO/TIM1_CH1	TIM1_CH1_1/TIM1_CH1_2/ TIM1_CH1_4
14	13	14	16	16	PB10	1/0	MV/PD	PB10	L01/TIM1_CH2N	TIM1_CH2N_1/TIM1_CH2N_2/ TIM1_CH2N_4
15	14	15	17	17	V <sub>S1</sub> <sup>(8)</sup>	Р	-	V <sub>S1</sub>		
16	16	16	18	18	<b>V</b> <sub>B1</sub> <sup>(9)</sup>	Р	-	$V_{B1}$		

										7
17	15	17	19	19	PB11	0	MVO	PB11	H01/TIM1_CH2	TIM1_CH2_1/TIM1_CH2_2/ TIM1_CH2_4
18	_	18	20	20	PB12	1/0	MV/PD	PB12	LO2/TIM1_CH3N	TIM1_CH3N_1/TIM1_CH3N_4/ TIM2_CH3_2/TIM2_CH1N_2/ TIM3_CH1N_4
19	14	19	21	21	<b>V</b> <sub>S2</sub> (8)	Р	_	V <sub>S2</sub>		
20	16	20	22	22	<b>V</b> <sub>B2</sub> <sup>(9)</sup>	Р	_	V <sub>B2</sub>		
21	17	21	23	23	PB13	0	MVO	PB13	H02/TIM1_CH3	TIM1_CH3_1/TIM1_CH3_4/ TIM2_CH1_ETR_2/ TIM3_CH1_ETR_4
-	_	22	24	24	PB14	1/0	MV/PD	PB14	L03	TIM1_CH3N_2/TIM2_CH4_2/ TIM2_CH2N_2/TIM3_CH2N_4
-	14	23	25	25	V <sub>S3</sub> <sup>(8)</sup>	Р	_	V <sub>S3</sub>		
_	16	24	26	26	<b>V</b> <sub>B3</sub> <sup>(9)</sup>	Р	-	<b>V</b> <sub>B3</sub>		
_	18	25	27	27	PB15	0	MVO	PB15	H03	TIM1_CH3_2/TIM1_CH4_1/ TIM2_CH2_2 (10) /TIM3_CH2_4
22	19	26	28	28	V <sub>DD8</sub>	Р	-	$V_{DD8}$		
-	_	_	29	_	PB7	0	HVOD	PB7		
-	-	27	30	29	PC0	1/0	-	PC0	TIM1_CH4/RST <sup>(4)</sup> TIM3_CH1_ETR/ UART_RX	TIM1_CH3N_3/TIM1_CH3N_4/ TIM3_CH1_ETR_1
-	-	28	31	30	PC1	1/0	-	PC1	TIM1_ETR/TIM3_CH2/ UART_TX	TIM1_ETR_1/TIM1_CH2N_3/ TIM1_CH2N_4/TIM3_CH1N_1/ UART_TX_1
_	_	29	_	31	PC2	1/0	-	PC2		TIM1_CH4_2/TIM1_CH1N_3/ TIM1_CH1N_4/UART_RX_1
-	-	30	32	32	PC3	1/0	_	PC3	SPI_MOSI	TIM1_CH1_3/TIM1_CH1_4
-	_	31	33	33	PC4	1/0	-	PC4	SPI_MISO	TIM1_CH2_3/TIM1_CH2_4/ SPI_MISO_2
_	20	32	34	_	PC5	1/0	HV	PC5		TIM1_CH4_3/ TIM2_CH2_2 (10)
23	21	33	35	34	V <sub>DD33</sub>	Р	_	$V_{\text{DD33}}$		
24	22	34	36	35	V <sub>HV</sub>	Р	-	$V_{HV}$		
25	_	-	-	36	GND	Р	-	GND		
_	23	35	37	37	PA0 (5)	1/0/A	-	PA0	ADC_IN13/CC1 (CC1R) /SPI_NSS	TIM1_CH3_3/TIM1_CH3_4/ SPI_NSS_2
-	24	36	38	38	PA1 (5)	1/0/A	-	PA1	ADC_IN14/CC2 (CC2R) /SPI_SCK	TIM1_CH4_4/SPI_SCK_2/ SPI_SCK_3
26	25	37	39	39	PA2 (5)	I/0/A	-	PA2	ADC_IN15/SWCLK/CC3	TIM3_CH1_ETR_3/ UART_RX_4/UART_TX_5/ UART_CTS_2/I2C_SCL_1/ I2C_SCL_3/SPI_NSS_1/ SPI_NSS_3

27	26	38	40	40	PA3 (5)	1/0/A	-	PA3	ADC_IN16/SWDIO/ SWIM/CC4/CMP3_P0	TIM2_CH1_ETR_1/ UART_RX_5/UART_TX_4/ I2C_SDA_3
28	27	39	41	41	PB0	1/0/A	_	PB0	ADC_IN11/UDP/ CMP3_P1	TIM2_CH2_1/UART_RX_3
1	28	40	42	42	PB1	1/0/A	-	PB1	ADC_IN12/UDM/ CMP3_P2	TIM2_CH3_1/TIM2_CH3_3/ TIM2_CH1N_1/TIM2_CH1N_3/ UART_TX_3
_	29	41	43	43	PA4 (6)	1/0/A	_	PA4	ADC_IN5/TIM2_CH4/ TIM2_CH2N/ISOURCE1	TIM1_ETR_2/TIM1_ETR_3/ TIM1_ETR_4/TIM3_CH1N_3/ UART_RTS_2/SPI_MISO_1/ SPI_MISO_3
-	-	42	44	44	PA5	1/0/A	-	PA5	ADC_IN6/ TIM2_CH1_ETR/ CMP3_NO/ISOURCE2	
_	29	43	45	45	PA6 (6)	1/0/A	_	PA6	TIM2_CH2/CMP3_N1/ ISINK1	
2	30	44	46	46	PA7	1/0/A	-	PA7	ADC_IN2/TIM2_CH3/ TIM2_CH1N/CMP3_N2/ ISINK2	
3	31	45	47	47	PA8	1/0/A	-	PA8	ADC_IN7/MCO/ CMP3_OUTO/ISN1	SPI_MOSI_3
4	32	46	48	48	ISP1	Α	_	ISP1		

注1:表格缩写解释:

I = TTL/CMOS电平斯密特输入,支持VD33电压范围的输入;

0 = CMOS电平三态输出,支持Vinsi电压范围的输出;

P = 电源:

MV = 预驱动电压引脚,支持 $V_{DS}$ 电压范围的输入和输出;

MVO = 预驱动电压引脚, 支持V∞电压范围的输出;

HV = 高压引脚, 支持Vm电压范围的输入和输出;

HVOD = 高压引脚,支持V₩电压范围的开漏输出;

PD = 内置不可关闭的下拉电阻, 可用于驱动N-MOSFET的栅极;

A = 模拟信号输入或输出,支持Viiisi电压范围。

- 注2: 重映射功能下划线后的数值表示AFIO寄存器中相对应位的配置值。例如: SPI\_MOSI\_2表示AFIO 寄存器相应位配置为10b。
- 注3:除PB7~PB15和PC5外,所有GP10引脚都支持可控上拉。PB0和PB1内置默认开启、可以调节、可以 关闭的下拉电阻,并可提供下拉电流;CC1/CC2/CC3/CC4如果有后缀R则表示内置Type-C规范定义 的可控Rd下拉电阻,默认开启;PA0/CC1R和PA1/CC2R引脚内置可控Rd下拉电阻;PB8、PB10、PB12、 PB14内置不可关闭的下拉电阻;除此之外的GP10引脚均未内置下拉电阻。
- 注4: 对于复位引脚,其位置选择由用户字配置位RST\_PIN\_SEL控制。当位RST\_PIN\_SEL = 1时,PA15 为复位引脚;当位RST PIN SEL = 0时,PCO为复位引脚。
- 注5: 当V<sub>H</sub> < 5V且PAO~PA3作为ADC输入通道或GP10推挽输出时,其电压范围约为0V~(V<sub>DD33</sub>-1.7V)。
- 注6:对于CH32M030K8U7芯片,PA4和PA6引脚在芯片内部短接合封,禁止将两个10均配置为输出功能。
- 注7: 对于CH32M030G8R7芯片, PB5和PA13引脚在芯片内部短接合封,禁止将两个10均配置为输出功能。
- 注8:对于CH32M030K8U7芯片,Vs1、Vs2和Vs3引脚在芯片内部短接合封。

注9:对于CH32M030K8U7芯片, VB1、VB2和VB3引脚在芯片内部短接合封。

注10: 当寄存器AFIO\_PCFR1的bit[11:10]TIM2\_RM = 10且TIM2\_CTLR1的bit[12]CH2\_PWMOUT\_EN = 1时, TIM2\_CH2的PWM输出改为PC5引脚输出。PC5用于TIM2\_CH2输出时为开源输出,若TIM2\_CH2为高电平, 则PC5为高电平状态;若TIM2\_CH2为低电平,则PC5为高阻态。

注11: 当PB4作为V<sub>HV</sub>分压监测功能使用时,输入电压须不超过V<sub>DD33</sub>-0.9V。

# 表2-2 CH32M030专有引脚以及功能说明

名称	描述说明
L00, L01, L02, L03	内部低侧栅极驱动器的输出,支持输入,控制N型MOSFET的栅极。
H00, H01, H02, H03	内部高侧栅极驱动器的输出,控制N型MOSFET的栅极。
$V_{s0}, V_{s1}, V_{s2}, V_{s3}$	内部高侧栅极驱动器的悬浮地。
V <sub>B0</sub> , V <sub>B1</sub> , V <sub>B2</sub> , V <sub>B3</sub>	内部高侧栅极驱动器的自举电源,建议外接1uF~10uF容量电容到各自的悬浮地。

# 2.3 引脚复用功能

注意,下表中的引脚功能描述针对的是所有功能,不涉及具体型号芯片。不同型号之间外设资源有差 异,查看前请先根据芯片型号资源表确认是否有此功能。

表2-3 引脚复用和重映射功能

复用 引脚	ADC	TIM1	T1M2/3	UART	SYS	USB	12C	SPI	ANA
PA0	ADC_IN13	TIM1_CH3_3 TIM1_CH3_4				CC1 (CC1R)		SPI_NSS SPI_NSS_2	
PA1	ADC_IN14	TIM1_CH4_4				CC2 (CC2R)		SPI_SCK SPI_SCK_2 SPI_SCK_3	
PA2	ADC_IN15		TIM3_CH1_ETR_3	UART_RX_4 UART_TX_5 UART_CTS_2	SWCLK	CC3	12C_SCL_1 12C_SCL_3	SPI_NSS_1 SPI_NSS_3	
PA3	ADC_IN16		TIM2_CH1_ETR_1	UART_RX_5 UART_TX_4	SWD10 SWIM	CC4	12C_SDA_3		CMP3_P0
PA4	ADC_IN5	TIM1_ETR_2 TIM1_ETR_3 TIM1_ETR_4	T I M2_CH4 T I M2_CH2N T I M3_CH1N_3	UART_RTS_2				SPI_MISO_1 SPI_MISO_3	I SOURCE1
PA5	ADC_IN6		TIM2_CH1_ETR						CMP3_N0 ISOURCE2
PA6			TIM2_CH2						CMP3_N1 ISINK1
PA7	ADC_IN2		TIM2_CH3 TIM2_CH1N						CMP3_N2 ISINK2
PA8	ADC_IN7				MCO			SPI_MOSI_3	CMP3_OUTO
PA10									ISP2
PA11	ADC_IN8							SPI_MOSI_2	ISN2
PA12	ADC_IN19								QII1
PA13	ADC_IN18	TIM1_BKIN_1							Q112
PA14	ADC_IN9 ADC_ETR			UART_CTS UART_CTS_1			12C_SDA_2		Q_DET1
PA15	ADC_IN10	TIM1_BKIN TIM1_BKIN_2 TIM1_BKIN_3 TIM1_BKIN_4		UART_RTS UART_RTS_1	RST		12C_SCL_2		Q_DET2
PB0	ADC_IN11		TIM2_CH2_1	UART_RX_3		UDP			CMP3_P1
PB1	ADC_IN12		TIM2_CH3_1 TIM2_CH3_3 TIM2_CH1N_1 TIM2_CH1N_3	UART_TX_3		UDM			 CMP3_P2
PB2	ADC_INO		TIM2_CH4_1 TIM2_CH4_3 TIM2_CH2N_1 TIM2_CH2N_3 TIM3_CH1_ETR_2 TIM3_CH2_1 TIM3_CH1N	UART_CTS_3 UART_CTS_4 UART_CTS_5			12C_SDA		CMP3_N3
PB3	ADC_IN1		TIM3_CH2_2 TIM3_CH2N TIM3_CH2N_1	UART_RTS_3 UART_RTS_4 UART_RTS_5			12C_SCL		CMP3_P3
PB4	ADC_IN17		TIM3_CH1N_2						CMP3_OUT1 V_DET
PB5	ADC_IN3		TIM3_CH2N_2 TIM3_CH2_3 TIM2_CH1_ETR_3	UART_RX_2	ΧI			SPI_MOSI_1	CMP3_OUT2 CMP2_P0
PB6	ADC_IN4 ADC_ETR_1		TIM2_CH2_3 TIM3_CH2N_3	UART_TX_2	XO		12C_SDA_1	SPI_SCK_1	CMP2_NO
PB8		TIM1_CH1N TIM1_CH1N_1 TIM1_CH1N_2 TIM1_CH1N_4							

复用引脚	ADC	TIM1	T1M2/3	UART	SYS	USB	120	SPI	ANA
J		TIM1_CH1							
PD0		TIM1_CH1_1							
PB9		T I M1_CH1_2							
		TIM1_CH1_4							
		TIM1_CH2N							
PB10		TIM1_CH2N_1							
PBIU		TIM1_CH2N_2							
		TIM1_CH2N_4							
		TIM1_CH2							
PB11		T I M1_CH2_1							
1011		T I M1_CH2_2							
		TIM1_CH2_4							
		TIM1_CH3N	T1M2_CH3_2						
PB12		TIM1_CH3N_1	TIM2_CH1N_2						
		TIM1_CH3N_4	TIM3_CH1N_4						
		TIM1_CH3	TIM2_CH1_ETR_2						
PB13		TIM1_CH3_1	TIM3_CH1_ETR_4						
		T I M1_CH3_4							
			T1M2_CH4_2						
PB14		TIM1_CH3N_2	TIM2_CH2N_2						
			TIM3_CH2N_4						
PB15		T I M1_CH3_2	TIM2_CH2_2						
		T I M1_CH4_1	TIM3_CH2_4						
		TIM1_CH4	TIM3_CH1_ETR						
PC0		TIM1_CH3N_3	TIM3_CH1_ETR_1	UART_RX	RST				
		TIM1_CH3N_4							
		TIM1_ETR	T.110 0110						
PC1		TIM1_ETR_1	TIM3_CH2	UART_TX					
		TIM1_CH2N_3	TIM3_CH1N_1	UART_TX_1					
		TIM1_CH2N_4							
D02		T I M1_CH4_2		HADT DV 4					
PC2		TIM1_CH1N_3		UART_RX_1					
		TIM1_CH1N_4							
PC3		TIM1_CH1_3						SPI_MOSI	
		TIM1_CH1_4						CDI MICO	
PC4		TIM1_CH2_3						SPI_MISO SPI_MISO_2	
DOE		TIM1_CH2_4	TIMO OUO O					371_W13U_Z	
PC5		TIM1_CH4_3	T1M2_CH2_2						

# 第3章 电气特性

## 3.1 测试条件

除非特殊说明和标注,所有电压都以GND为基准。

所有最小值和最大值将在最坏的环境温度、供电电压和时钟频率条件下得到保证。典型数值可基于以下三种环境之一用于设计指导:

- 1、单Ⅴ₩供电, 常温25℃、Ⅴ₩ = 12Ⅴ;
- 2、外部直接为V<sub>DD8</sub>供电, 常温25°C、V<sub>HV</sub> = 12V、V<sub>DD8</sub> = 8V, 此时要求V<sub>DD8</sub> ≤ V<sub>HV</sub>;
- 3、外部直接为V<sub>DD33</sub>和V<sub>DD8</sub>供电,常温25°C、V<sub>HV</sub> = 12V、V<sub>DD8</sub> = 8V、V<sub>DD33</sub> = 3.3V,此时要求V<sub>DD33</sub> ≤ V<sub>DD8</sub> ≤ V<sub>HV</sub>。

对于通过综合评估、设计模拟或工艺特性得到的数据,不会在生产线进行测试。在综合评估的基础上,最小和最大值是通过样本测试后统计得到。除非特殊说明为实测值,否则特性参数以综合评估或设计保证。

#### 供电方案:

 $V_{B0}$  $V_{HV}$ 1uF  $V_{HV}$ 10uF GND High Voltage  $V_{B1}$ Regulator 1uF  $V_{DD8}$ 10uF 0.1uF  $V_{B2}$ GND Low Voltage Regulator 1uF  $V_{DD33}$ 1uF  $V_{B3}$ 

GND

1uF

图3-1-1 常规供电典型电路(单V₩供电)

图3-1-2 常规供电典型电路(外部直接为Ⅷ供电)

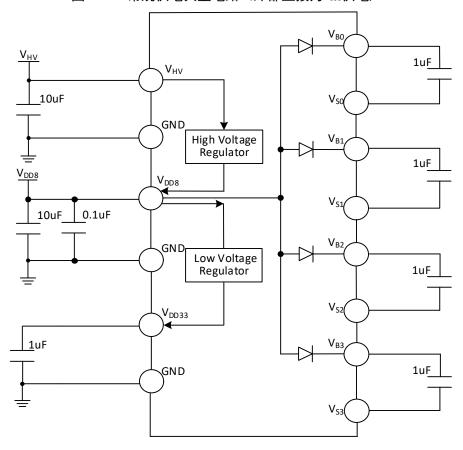
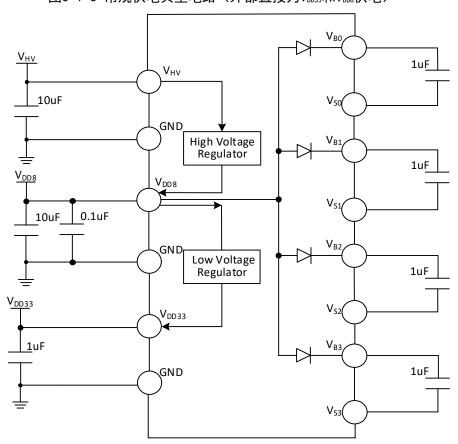


图3-1-3 常规供电典型电路(外部直接为V<sub>0033</sub>和V<sub>008</sub>供电)



# 3.2 绝对最大值

临界或者超过绝对最大值将可能导致芯片工作不正常甚至损坏。

表3-1 绝对最大值参数表

符号		描述	最小值	最大值	单位
TA	工作时的环境温度	CH32M030C8T7、CH32M030C8U7 CH32M030G8R7、CH32M030K8U7	-40	105	°C
		CH32M030C8U3	-40	125	°C
Ts	存储时的环境温度		-40	150	°C
V <sub>HV</sub> -GND	外部主供电电压(V๗)		-0. 3	30	V
V <sub>DD8</sub> -GND	内部低压调压器和MV I/0引	脚的供电电压(V <sub>DB</sub> )	-0. 3	12	V
V <sub>DD33</sub> -GND	普通1/0引脚和模拟部分的	电源电压(V <sub>DD33</sub> )	-0. 3	3. 8	٧
	HV高压I/0引脚PC5上的输入	<b>、</b> 电压	-0. 3	V <sub>HV</sub> +7	٧
VIN	HV高压I/0引脚PB7上的电压	<u>E</u>	-0. 3	40	٧
V IN	耐高压I/0引脚CCx上的输入	(电压(可能有漏电)	-0. 3	28	٧
	普通1/0引脚上的输入电压		-0. 3	V <sub>DD33</sub> +0. 3	٧
$V_{B}$	高侧自举电源电压		-0. 3	40	٧
V <sub>BPEAK</sub>	高侧自举1%占空比脉冲电压	E	-0. 3	42	٧
Vs	高侧悬浮地电压		-2	30	٧
V <sub>SPEAK</sub>	高侧悬浮地1%占空比脉冲电	- 	-5	32	٧
V <sub>B_S</sub>	高侧自举电源相对悬浮地的	为压差	-0. 3	12	٧
V <sub>HO</sub>	高侧驱动器的输出电压		V₅-0. 3	V <sub>B</sub> +0. 3	٧
V <sub>LO</sub>	低侧驱动器的输出电压		-0. 3	V <sub>DD8</sub> +0. 3	٧
V <sub>ESD</sub> (HBM)	对外引脚USB和PD的ESD静电	B放电电压(HBM)	4	K	٧
V ESD (HBM)	其它引脚的ESD静电放电电	压(HBM)	2	K	٧
I PEAKVB	№内置二极管1%占空比脉冲	·输出电流		70	mA
I AVVB	V₅内置二极管连续输出电流	Ε		7	mA
I <sub>vhv</sub>	所有Vℼ引脚连续输入电流	(供应电流)		60	mA
I <sub>GND</sub>	所有GND公共地引脚的合计	总电流(流出电流)		200	mA
	HV高压I/0引脚上的灌电流	或源电流		+/-5	mA
I 10	MV预驱动1/0引脚上的灌电	流或源电流		+/-80	mA
	其它普通I/0引脚上的sink	灌电流或source源电流		+/-30	mA
	HSE的XI引脚			+/-4	mA
INJ (PIN)	其它引脚的注入电流			+/-4	mA
Σ I INJ (PIN)	所有10和控制引脚的总注)	电流		+/-20	mA

# 3.3 电气参数

## 3.3.1 工作条件

## 表3-2 通用工作条件

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
_	内部HB时钟频率	$T_A = -40^{\circ}C \sim 105^{\circ}C$		72	MHz
FHCLK	八百四四	$T_A = -40^{\circ}C \sim 125^{\circ}C$		68	MHz
$V_{\scriptscriptstyle HV}$	内部高压调压器和HV I/0引脚的电源	$T_A = -40^{\circ}C \sim 105^{\circ}C$	4. 0	29. 0	٧

	电压	$T_A = -40^{\circ}C \sim 125^{\circ}C$	4. 3	28. 0	٧
\ \ \	内部低压调压器和MV I/O引脚的电源	$T_A = -40^{\circ}C \sim 105^{\circ}C$	4. 0	10. 5	٧
$V_{DD8}$	电压	$T_A = -40^{\circ}C \sim 125^{\circ}C$	4. 3	10. 0	٧
V <sub>DD33</sub>	普通1/0引脚和模拟部分的电源电压		3. 1	3. 5	٧
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	<b>吉伽目河州中</b> [	$T_A = -40^{\circ}C \sim 105^{\circ}C$	-2. 0	29. 0	٧
<b>V</b> s	· 高侧悬浮地电压 ·	$T_A = -40^{\circ}C \sim 125^{\circ}C$	-2. 0	28. 0	٧

#### 表3-3 上电和掉电条件

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
	V <sub>HV</sub> 上升速率		0. 1	∞	us/V
Туну	V <sub>HV</sub> 下降速率		40	∞	us/V

## 3.3.2 内置复位和电源模块特性

#### 表3-4 复位和调压器及电压监测

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位	
		VDD33上升沿阈值	2. 8	3. 0	3. 1	V	
$V_{\text{POR/PDR}}$	上电/掉电复位阈值	VDD33下降沿阈值	2. 6	2. 9	3. 0	V	
		Vɒ₃阈值	3. 05	3. 15	3. 25	V	
$V_{ t PDRhyst}$	PDR迟滞	V <sub>DD33</sub> 阈值		100	150	mV	
<b>V</b> <sub>0VP_REF</sub> (3)	0VP过压复位阈值电压	上升沿		1. 5		V	
V OVP_REF	UVF过压发证网值电压	下降沿		1. 45		V	
		$VDD8\_SEL[1:0] = 00$ <u>H</u>	4. 9	5. 0	5. 1	v	
V <sub>DD8</sub>	高压调压器的输出电压	V <sub>HV</sub> ≥ 5.8V	4. 7	3. 0	J. 1	<b>V</b>	
V DD8	同区例还给的制山电压	$VDD8\_SEL[1:0] = 01且$	7. 8	8. 0	8. 2	v	
		V <sub>HV</sub> ≥ 8.8V	7.0	0.0	0. 2	, v	
I <sub>VDD8</sub>	高压调压器的负载电流				35	mA	
1 VDU8	(含MV I/O和低压调压器	<b>器等所有负载)</b>			33	ША	
$V_{DD33}$	低压调压器的输出电压		3. 24	3. 3	3. 36	V	
l <sub>VDD33</sub>	低压调压器的负载电流				20	mA	
1 40033	(含普通1/0和内核调压	器等所有负载)			20	1117 (	
Тотр	0TP过温保护的温度点	升温过程	130	145	160	°C	
101P	解除过温保护的温度点	降温过程	125	135	150	°C	
t <sub>rst</sub>	上电复位延时			3 (2)		ms	
LRST	其他复位延时			300		us	

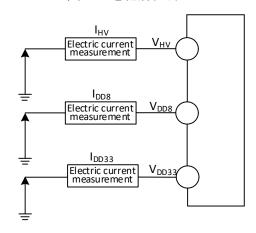
#### 注: 1. 常温测试值。

- 2. 用户配置位RST\_MODE可以增加上电复位延时。
- 3. Vove\_REF需要结合片外电阻分压的比例,来决定V<sub>HV</sub>电压的过压保护点。例如:上电阻200K和下电阻 15K将得到约21. 5V的过压复位电压。

#### 3.3.3 供电电流特性

电流消耗是多种参数和因素的综合指标,这些参数和因素包括工作电压、环境温度、I/0引脚的负载、软件配置、工作频率、I/0脚的翻转速率、程序在存储器中的位置以及执行的代码等。电流消耗测量方法如下图:

图3-2 电流消耗测量



#### 微控制器处于下列条件:

常温 $V_{HV}$  = 12V ( $V_{DDS}$  = 8V 、 $V_{DDSS}$  = 3.3V) 情况下,测试时:支持上拉输入的I/O口配置成上拉输入模式,其他配置为模拟输入模式。HSE = 8M 、HSI = 8M (已校准)。使能或关闭所有外设时钟的功耗。

表3-5 运行模式下典型的电流消耗,数据处理代码从内部闪存中运行

符号	参数	夕 //		典型	D 位	单位	
175	多数	条件 		使能所有外设	关闭所有外设	半江	
		<b>运行工会法办</b> 如	$F_{HCLK} = 72MHz$	12. 0	6. 3		
		运行于高速内部 RC振荡器(HSI),	$F_{HCLK} = 48MHz$	9. 0	4. 9		
		使用HB预分频以 -	•	F <sub>HCLK</sub> = 24MHz	5. 9	3. 5	mA
	运行模式下的供 运中流		$F_{HCLK} = 8MHz$	1. 9	1. 4		
1		<b>一                                    </b>	$F_{HCLK} = 4MHz$	1. 4	1. 1		
I HV		应电流	应电流		$F_{HCLK} = 72MHz$	12. 2	6. 5
		运行于高速外部 时钟(HSE),使用	$F_{HCLK} = 48MHz$	9. 2	5. 1		
	HB 预分频以减低 频率	,	$F_{HCLK} = 24MHz$	6. 1	3. 7	mA	
		$F_{HCLK} = 8MHz$	2. 1	1. 6			
		<b>少</b> 火 <del>干</del>	$F_{HCLK} = 4MHz$	1. 6	1. 3		

注: 以上为实测参数。

表3-6 睡眠模式下典型的电流消耗,数据处理代码从内部闪存中运行

符号	参数	条件		典型	型 <b>值</b>	单位
1寸 <i>节</i>	多数	余片			关闭所有外设	半江
			$F_{HCLK} = 72MHz$	9. 5	3. 9	
İ		运行于高速内部	$F_{HCLK} = 48MHz$	7. 1	3. 1	
		<b>減低频</b> 率	F <sub>HCLK</sub> = 24MHz	4. 7	2. 3	mA
	SLEEP睡眠模式 下的供应电流		$F_{HCLK} = 8MHz$	1. 1	0. 6	
I <sub>HV</sub>	「的		<b>一 小火 IKC少火<del>・コー</del></b>	F <sub>HCLK</sub> = 4MHz	0. 7	0. 5
	和时钟保持)	运行于高速外部	F <sub>HCLK</sub> = 72MHz	9. 9	4. 2	
			时钟(HSE),使用	F <sub>HCLK</sub> = 48MHz	7. 5	3. 4
		HB 预分频以减低	F <sub>HCLK</sub> = 24MHz	5. 0	2. 6	mA
		频率	F <sub>HCLK</sub> = 8MHz	1.4	0. 9	

	L	1 ()	0.8	
	FHCLK - 4WITZ	1. 0	0.0	

注: 以上为实测参数。

表3-7 待机模式下典型的电流消耗

符号	参数	条件		典型值	单位
		$V_{HV} = 12V \cdot V_{DD8} = 5V$		104	
	CTOD信止描光工的供应由达	$V_{HV} = 12V \cdot V_{DD8} = 8V$		114	
	STOP停止模式下的供应电流	$V_{HV} = 12V \cdot V_{DD8} = 9V$		123	uA
	,	$V_{HV} = 12V$ , $V_{DD8} = 10$	V	133	
İ		V - 40V V - 5V	LSI打开	76	
I <sub>HV</sub>		$V_{HV} = 12V$ , $V_{DD8} = 5V$	LSI关闭	74	
		V 40V V 0V	LSI打开	94	
	STANDBY待机模式下的供应电流	$V_{HV} = 12V$ , $V_{DD8} = 8V$	LSI关闭	92	uA
	101/11001 137/11天文 下山为水丛 毛洲	$V_{HV} = 12V, V_{DD8} = 9V$	LSI打开	102	
		VHV — IZV, VDD8 — 9V	LSI关闭	102	
		V 40V V 40V	LSI打开	114	
		$V_{HV} = 12V$ , $V_{DD8} = 10V$	LSI关闭	114	

注: 以上为实测参数。

## 3.3.4 外部时钟源特性

表3-8 来自外部高速时钟

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
F <sub>HSE_ext</sub>	外部时钟频率		4	8	25	MHz
V <sub>HSEH</sub> <sup>(1)</sup>	XI输入引脚高电平电压		0. 8*V <sub>DD33</sub>		V <sub>DD33</sub>	٧
V <sub>HSEL</sub> <sup>(1)</sup>	XI输入引脚低电平电压		0		0. 2*V <sub>DD33</sub>	٧
$C_{in(HSE)}$	XI输入电容			5		pF
DuCy <sub>(HSE)</sub>	占空比(Duty cycle)		40	50	60	%
I١	XI输入漏电流				±1	uA

注: 1. 不满足此条件可能会引起电平识别错误。

图3-3 外部提供高频时钟源电路

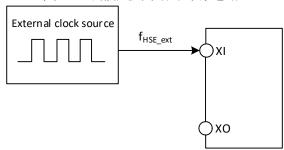


表3-9 使用一个晶体/陶瓷谐振器产生的高速外部时钟

┃ 符号 │ 易小値│ 無型値│ 最大値│ 』						
	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位

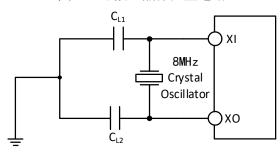
F <sub>x1</sub>	谐振器频率		4	8	25	MHz
$R_{\scriptscriptstyle F}$	反馈电阻 (无需外置)			250		kΩ
$C_{LOAD}$	建议的负载电容与对应晶体 串行阻抗R <sub>s</sub>	$R_{s} = 60 \Omega^{(1)}$		20		pF
12	HSE驱动电流	V <sub>DD33</sub> = 3.3V <b>,</b> 20p负载		0. 3		mA
gm	振荡器的跨导	启动		16		mA/V
t <sub>SU (HSE)</sub>	启动时间	V∞是稳定		2 (2)		ms

- 注: 1.25M晶体ESR建议不超过80欧, 低于25M可适当放宽。
  - 2. 启动时间指从HSEON开启到HSERDY被置位的时间差。

## 电路参考设计及要求:

晶体的负载电容以晶体厂商建议为准,通常情况CL1 = CL2。

图3-4 外接8M晶体典型电路



## 3.3.5 内部时钟源特性

表3-10 内部高速(HSI)RC振荡器特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
F <sub>HS1</sub>	频率(校准后)			8		MHz
DuCy <sub>HS1</sub>	占空比		45	50	55	%
		$T_A = 0^{\circ}C \sim 70^{\circ}C$	-1.5		1. 5	%
ACC <sub>HS1</sub>	HSI振荡器的精度(校准后)	$T_A = -40^{\circ}C \sim 85^{\circ}C$	-2. 0		2. 0	%
		$T_A = -40^{\circ}C \sim 125^{\circ}C$	-2. 2		2. 2	%
t <sub>su(HSI)</sub>	HSI振荡器启动稳定时间			10		us
DD (HSI)	HSI振荡器功耗		120	180	270	uA

## 表3-11 内部低速(LSI)RC振荡器特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
F <sub>LS1</sub>	频率		240	340	450	kHz
DuTy <sub>LS1</sub>	占空比		45	50	55	%
t <sub>SU(LSI)</sub>	LSI振荡器启动稳定时间			80		us
I DD (LSI)	LSI振荡器功耗			2		uA

## 3.3.6 从低功耗模式唤醒的时间

## 表3-12 低功耗模式唤醒的时间(1)

符号	参数	条件	典型值	单位
twusleep	从睡眠模式唤醒	使用HSI RC时钟唤醒	24	us
t <sub>WUSTOP</sub>	从停止模式唤醒	使用HSI RC时钟唤醒	255	us

twustdby	从待机模式唤醒	LDO稳定时间 + HSI RC时钟唤醒	260	us

## 注:以上为实测参数。

#### 3.3.7 存储器特性

#### 表3-13 闪存存储器特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
t <sub>prog_page</sub>	页(128字节)编程时间		3. 9	4. 5	5. 1	ms
t <sub>erase_page</sub>	页(128字节)擦除时间		3. 9	4. 5	5. 1	ms
t <sub>ME</sub>	整片擦除时间		3. 9	4. 5	5. 1	ms

#### 表3-14 闪存存储器寿命和数据保存期限

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
N <sub>END</sub>	擦写次数	$T_A = 25^{\circ}C$	10K	50K <sup>(1)</sup>		次
	· 探与人奴	$T_A = 125^{\circ}C$	1K	5K <sup>(1)</sup>		次
t <sub>RET</sub>	数据保存期限		10			年

## 注: 1. 实测操作擦写次数, 非担保。

## 3.3.8 普通1/0引脚特性

## 表3-15 普通1/0引脚静态特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
$V_{DD33}$	供电电压		3. 1	3. 3	3. 5	٧
V <sub>IH</sub>	1/0引脚输入高电平电压	$V_{DD33} = 3.3V$	1.8		$V_{DD33}$	٧
VIL	1/0引脚输入低电平电压	$V_{DD33} = 3.3V$	0		0.8	٧
$V_{hys}$	施密特触发器迟滞电压	$V_{DD33} = 3.3V$		300		mV
l <sub>Ikg</sub>	1/0引脚输入漏电流			0	+/-3	u <b>A</b>
R <sub>PU</sub>	上拉等效电阻		30	45	60	kΩ
Cıo	I/0引脚电容			5		pF

#### 表3-16 普通1/0引脚输出驱动电流特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
I <sub>SINK</sub>	引脚输出低电平的灌电流	V <sub>DD33</sub> = 3.3V, 引脚电压=0.4V	14	20	27	mA
I SOURCE	引脚输出高电平的源电流	V <sub>DD33</sub> = 3.3V,引脚电压=V <sub>DD33</sub> -0.4V	13	18	24	mA

## 表3-17 普通1/0引脚输出电压特性

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
$V_{0L}$	输出低电平,单个引脚吸收8mA电流	V <sub>DD33</sub> ≥ 3V		0. 5	٧
$V_{\text{OH}}$	输出高电平,单个引脚输出8mA电流	V <sub>DD33</sub> ≥ 3V	V <sub>DD33</sub> -0. 5		٧

## 注: 1. 当V<sub>HV</sub> < 5V且PAO~PA3输出高电平时, 电压达不到V<sub>DD3</sub>满幅, 约为V<sub>DD3</sub>-1. 7V。

2. 以上条件中如果多个I/0引脚同时驱动,电流总和不能超过表3. 2节给出的绝对最大额定值。另外多个I/0引脚同时驱动时,电源/地线引脚上的电流较大,会产生压降使内部I/0的电压达不到表中电源电压,从而导致驱动电流小于标称值。

#### 表3-18 普通1/0引脚输入输出交流特性

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
F <sub>max(10) out</sub>	1/0引脚输出最高频率	$CL = 50pF, V_{DD33} \geqslant 3V$		30	MHz
t <sub>f(10)out</sub>	输出高至低电平的下降时间	01 - 50 5 1/ > 01/		12	ns
t <sub>r (10) out</sub>	输出低至高电平的上升时间	$-$ CL = 50pF, $V_{DD33} \geqslant 3V$		12	ns
t <sub>EXTIpw</sub>	EXTI控制器检测到外部信号的脉冲宽度		12		ns

#### 3.3.9 MV I/O引脚特性

#### 表3-19 MV I/0引脚静态特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
$V_{DD8}$	供电电压		4. 0	8. 0	10. 5	٧
V <sub>IH</sub>	1/0引脚输入高电平电压		2. 0		V <sub>DD8</sub>	٧
V <sub>IL</sub>	1/0引脚输入低电平电压		0		0. 7	٧
V <sub>hys</sub>	施密特触发器迟滞电压			500		mV
1 ,	1/021 脚烧 ) 泥山 法	引脚电压 = GND	-5	0	5	uA
lkg	I/0引脚输入漏电流 	引脚电压 = 5V	30	42	63	uA
R <sub>PD</sub>	下拉等效电阻		80	120	170	kΩ
Cıo	I/0引脚电容			10		pF

#### 表3-20 MV I/0引脚输出驱动电流特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
	引脚输出低电平的灌电流	V <sub>DD8</sub> = 8V, 引脚电压= 0.5V	75	110	145	mA
	引脚输出低电平的短路电流	V <sub>DD8</sub> = 8V, 引脚电压= V <sub>DD8</sub>		620		mA
LSINK	引脚输出低电平的灌电流	V <sub>DD8</sub> = 5V,引脚电压= 0.5V	60	90	120	mA
	引脚输出低电平的短路电流	V <sub>DD8</sub> = 5V,引脚电压= V <sub>DD8</sub>		320		mA
	引脚输出低电平的灌电流	V <sub>DD8</sub> = 10V,引脚电压= 0.5V	80	120	160	mA
	引脚输出低电平的短路电流	V <sub>DD8</sub> = 10V,引脚电压= V <sub>DD8</sub>		740		mA
	引脚输出高电平的源电流	V <sub>DD8</sub> = 8V,引脚电压= V <sub>DD8</sub> -0.5V	30	50	65	mA
	引脚输出高电平的短路电流	V <sub>DD8</sub> = 8V, 引脚电压= GND		350		mA
1,	引脚输出高电平的源电流	V <sub>DD8</sub> = 5V,引脚电压= V <sub>DD8</sub> -0.5V	25	38	55	mΑ
LSOURCE	引脚输出高电平的短路电流	V <sub>DD8</sub> = 5V, 引脚电压= GND		170		mA
	引脚输出高电平的源电流	V <sub>DD8</sub> = 10V,引脚电压= V <sub>DD8</sub> -0.5V	35	55	75	mA
	引脚输出高电平的短路电流	V <sub>DD8</sub> = 10V, 引脚电压= GND		480		mA

注: 1. 对于HO引脚,高电平对应V<sub>8</sub>电压,低电平对应V<sub>8</sub>电压,测试条件基于两者差值V<sub>8.8</sub>电压,V<sub>8.8</sub>电压 条件参考上述V<sub>888</sub>的值。

2. 测试引脚电流、驱动器短路电流时,建议采用低占空比脉冲测试且考虑芯片及时散热。

#### 表3-21 MV I/0引脚输出电压特性

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
$V_{\text{LOL}}$	输出低电平,单个引脚吸收50mA灌电流	5V ≤ V <sub>DD8</sub> ≤ 10V		0. 5	٧
V <sub>LOH</sub>	输出高电平,单个引脚输出25mA源电流	5V ≤ V <sub>DD8</sub> ≤ 10V	V <sub>DD8</sub> -0.5		٧

注:以上条件中如果多个I/0引脚同时驱动,电流总和不能超过表3.2节给出的绝对最大额定值。另外 多个I/0引脚同时驱动时,电源/地线引脚上的电流较大,会产生压降使内部I/0的电压达不到表中电源 电压,从而导致驱动电流小于标称值。

## 表3-22 MV I/0引脚输入输出交流特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
F <sub>Lmax</sub> (10) out	t I/0引脚输出最高频率	CL = 2000pF,			400	kHz
		$5V \leqslant V_{DD8} \leqslant 10V$			400	КПZ
t <sub>Lf(I0)out</sub>	输出高至低电平的下降时间	CL = 2000pF,		35	70	ns
t <sub>Lr (10) out</sub>	输出低至高电平的上升时间	$5V \leqslant V_{DD8} \leqslant 10V$		50	100	ns
t <sub>LEXTIPW</sub>	EXTI控制器检测到外部信号的脉		12			
	冲宽度		12			ns

#### 3.3.10 HV I/O引脚特性

#### 表3-23 HV I/0引脚静态特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
$V_{\scriptscriptstyle HV}$	供电电压		4. 0		29. 0	٧
V <sub>HPC5</sub>	PC5不输出时的引脚耐压			$V_{\scriptscriptstyle HV}$	V <sub>HV</sub> +6	٧
$V_{HPB7}$	PB7不输出时的引脚耐压			$V_{\scriptscriptstyle HV}$	38	٧
$V_{HIH}$	1/0引脚输入高电平电压		2. 0		V <sub>HV</sub>	٧
V <sub>HIL</sub>	1/0引脚输入低电平电压		0		0. 7	٧
$V_{Hhys}$	施密特触发器迟滞电压			500		mV
I HIkg	1/0引脚输入漏电流		-5	0	5	uA
Сніо	1/0引脚电容			8		рF

## 表3-24 HV I/0引脚输出驱动电流特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
	引脚输出低电平的灌电流	V₁√ = 29V,引脚电压= 0.5V	0.8	1. 2	1.6	mA
Luciar	引脚输出低电平的短路电流	V <sub>HV</sub> = 29V, 引脚电压= V <sub>HV</sub>		5		mA
HSINK	引脚输出低电平的灌电流	V <sub>HV</sub> = 8V, 引脚电压= 0.5V	0.8	1. 2	1.6	mA
	引脚输出低电平的短路电流	V <sub>HV</sub> = 8V, 引脚电压= V <sub>HV</sub>		5		mA
	引脚输出高电平的源电流	V <sub>HV</sub> = 29V, 引脚电压= V <sub>HV</sub> -0.5V	0. 5	0. 9	1. 3	mA
Ι,	引脚输出高电平的短路电流	V₁√ = 29V,引脚电压= 0		8		mA
HSOURCE	引脚输出高电平的源电流	V <sub>HV</sub> = 8V,引脚电压= V <sub>HV</sub> -0.5V	0. 5	0. 9	1. 3	mA
	引脚输出高电平的短路电流	V <sub>HV</sub> = 8V, 引脚电压= 0		8		mA

注:测试引脚电流、驱动器短路电流时,建议采用低占空比脉冲测试且考虑芯片及时散热。

#### 表3-25 HV I/0引脚输出电压特性

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
$V_{HOL}$	输出低电平,单个引脚吸收2mA电流	5V ≤ V <sub>HV</sub> ≤ 12V		0. 5	٧
$V_{HOH}$	输出高电平,单个引脚输出0.2mA电流	5V ≤ V <sub>HV</sub> ≤ 12V	V <sub>HV</sub> -0. 5		٧

注:以上条件中如果多个I/0引脚同时驱动,电流总和不能超过表3.2节给出的绝对最大额定值。另外 多个I/0引脚同时驱动时,电源/地线引脚上的电流较大,会产生压降使内部I/0的电压达不到表中电源 电压,从而导致驱动电流小于标称值。

## 表3-26 HV I/0引脚输入输出交流特性

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
F <sub>Hmax(10) out</sub>	I/0引脚输出最高频率	CL = 20pF,		100	kHz

		$4V \leqslant V_{HV} \leqslant 29V$			
t <sub>Hf(I0)out</sub>	输出高至低电平的下降时间	CL = 20pF,		100	ns
t <sub>Hr (10) out</sub>	输出低至高电平的上升时间	$4V \leqslant V_{HV} \leqslant 29V$		100	ns
t <sub>HEXTIpw</sub>	EXTI控制器检测到外部信号的脉冲宽度		12		ns

## 3.3.11 USB/BC接口UDP和UDM特性

## 表3-27 USB/BC接口I/0引脚特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
$V_{DD33}$	USB工作电压		3. 1	3. 3	3. 5	٧
V <sub>SE</sub>	单端接收器阈值	额定电压	1. 2		1. 9	٧
R <sub>PU</sub>	BC引脚上拉等效电阻	DAC = 100000	20	31	45	kΩ
R <sub>PD</sub>	BC引脚下拉等效电阻	DAC = 100000	20	31	45	kΩ
I <sub>PU2</sub>	BC引脚弱上拉电流	PCS = 10, BC输出电压为0.6V	7	10	15	uA
I <sub>PD3</sub>	BC引脚弱下拉电流	PCS = 11, BC输出电压为0.6V	1	2	5	uA
I <sub>PD1</sub>	BC引脚下拉电流	PCS = 01, BC输出电压为0.6V	55	80	120	uA
ET	DAC总偏差	$V_{DD33} = 3.3V$		0. 3	1	LSB
$V_{ extsf{DACmax}}$	DAC最高输出电压	V <sub>DD33</sub> = 3.3V, 无阻性负载	3. 2	3. 25		٧
$V_{ extsf{DACmin}}$	DAC最低输出电压	V <sub>DD33</sub> = 3.3V, 无阻性负载		0	0. 02	٧
		V <sub>DD33</sub> = 3.3V, 关闭DAC缓冲器	12	15. 5	20	kΩ
R <sub>DAC</sub>	DAC输出阻抗	V <sub>DD33</sub> = 3.3V, 开启DAC缓冲器, 0.1V≤V <sub>DAGB_OUT</sub> (1) ≤V <sub>DD33</sub> -0.1V		17	25	Ω
I DDDAC	DAC缓冲器供电电流			135		uA
V <sub>DACBmax</sub>	带缓冲器DAC最高输出电压	V <sub>DD33</sub> = 3.3V, 负载10kΩ下拉	3. 1	3. 2		٧
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	带缓冲器DAC最低输出电压	V <sub>DD33</sub> = 3.3V, 负载10kΩ下拉		0. 005	0. 02	٧
VDACBmin	市场/中命DNU取版制山电压	V <sub>DD33</sub> = 3.3V, 负载10kΩ上拉		0. 08	0. 15	٧
tBuf	DAC缓冲器作为比较器用的输出延时			400	800	ns

注: VDACB\_OUT 为带缓冲器DAC的输出电压。

## 3.3.12 USB PD接口特性

## 表3-28-1 PD接口I/0引脚特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
tRise	上升时间	幅度10%到90%之间的时间,无负载	300	430	600	ns
tFall	下降时间	幅度10%到90%之间的时间,无负载	300	430	600	ns
vSwing	输出电压摆幅(	峰−峰值)	1. 00	1. 12	1. 20	٧
zDriver	输出阻抗	V <sub>DD33</sub> = 3.3V, PD接口输出1.12V	26		90	Ω
Zuriver	押山性机	V <sub>DD33</sub> = 3.3V, PD接口输出3.3V		40		Ω

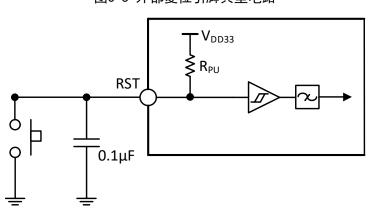
# 表3-28-2 Type-C接口I/O引脚特性(USBPDx\_CC\_HVT = 0时电压值参考普通I/O引脚)

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V <sub>ссін</sub>	CC引脚输入高电平电压	V <sub>DD33</sub> = 3.3V, USBPDx_CC_HVT = 1 (x=0,1)	2. 1		V <sub>DD33</sub>	V
V <sub>CCIL</sub>	CC引脚输入低电平电压	V <sub>DD33</sub> = 3.3V, USBPDx_CC_HVT = 1 (x=0,1)	0		1. 9	V
V <sub>CChys</sub>	施密特触发器迟滞电压	$V_{DD33} = 3.3V,$		200		mV

		USBPDx_CC_HVT = 1 (x=0, 1)				
		$CCx_PU = 11 (x=1, 2),$	68	80	92	uA
	I <sub>Pucc</sub> CC引脚上拉电流	PAD < V <sub>DD33</sub> -0. 6V	00	80	72	uA
l ,		$CCx_PU = 10 (x=1, 2),$	150	180	210	uA
TPUCC   COSTMULIVE流		PAD < V <sub>DD33</sub> -0. 6V	130 160		210	uA
		$CCx_PU = 01 (x=1, 2),$	280	330	380	uA
		PAD < V <sub>DD33</sub> -0. 6V	200	330	360	
Rd	CC引脚内置的Rd下拉电阻	$CCx_PD = 1 (x=1, 2),$	4. 08	5. 1	6. 12	kΩ
Ku	(适用于带R后缀的CCxR)	V <sub>DD33</sub> ≥ 3.1V或外部上拉330uA	4. 00	5. 1	0.12	K \$2
$R_{wpd}$	CC引脚内置的弱下拉电阻	$CCx_PD = 0 (x=1, 2)$	250	600		kΩ
	│ ├CC引脚ADC转换电压范围	V <sub>HV</sub> > 5V	0		V <sub>DD33</sub>	٧
VAINCC	VAINCE GOSTMADO转换电压范围	V <sub>HV</sub> < 5V	0		V <sub>DD33</sub> -1.7	٧

# 3.3.13 RST引脚特性 电路参考设计及要求:

图3-5 外部复位引脚典型电路



注:图中的电容是可选的,可以用于滤除按键抖动。

表3-29 外部复位引脚特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V <sub>IL (RST)</sub>	RST输入低电平电压	$V_{DD33} = 3.3V$	0		0.8	٧
V <sub>IH(RST)</sub>	RST输入高电平电压	V <sub>DD33</sub> = 3.3V	1.8		V <sub>DD33</sub>	٧
V <sub>hys (RST)</sub>	RST施密特触发器迟滞电压		200			mV
R <sub>PU</sub>	上拉等效电阻		30	45	60	kΩ
V <sub>F (RST)</sub>	RST输入可被滤波脉宽				60	ns
V <sub>NF (RST)</sub>	RST输入无法滤波脉宽		230			ns

## 3.3.14 TIM定时器特性

## 表3-30 TIMx特性

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
t <sub>res(TIM)</sub>	<b>中田田</b> 其体叶结		1		t <sub>TIM×CLK</sub>
	定时器基准时钟	f <sub>TIMxCLK</sub> = 48MHz	20. 8		ns
F <sub>EXT</sub>	CH1至CH3的定时器外部时钟频率		0	f <sub>TIMxCLK</sub> /2	MHz
	CDT 至CDS的定的命外部的研测率	f <sub>TIMxCLK</sub> = 48MHz	0	24	MHz

R <sub>esTIM</sub>	定时器分辨率			16	位
当选择了内部时钟时,16位计数器时 钟周期		1	65536	t <sub>TIM×CLK</sub>	
	钟周期	f <sub>TIMxCLK</sub> = 48MHz	0. 0208	1363	us
t <sub>MAX_COUNT</sub> 最大可能的计数	是十可丝的计数			65535	t <sub>TIM×CLK</sub>
	取入り貼切り数	f <sub>TIMxCLK</sub> = 48MHz		1363	us

# 3.3.15 I2C接口特性

图3-6 12C总线时序图

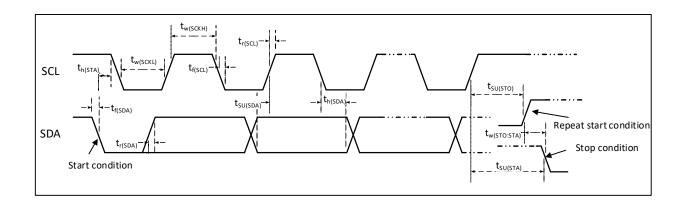


表3-31 120接口特性

<i>γ</i> γ □	<b>↔</b> ₩-	标准	12C	快速	12C	单位 us us ns
符号	参数	最小值	最大值	最小值	最大值	平14
t <sub>w(SCKL)</sub>	SCL时钟低电平时间	4. 7		1. 2		us
t <sub>w(SCKH)</sub>	SCL时钟高电平时间	4. 0		0.6		us
t <sub>SU(SDA)</sub>	SDA数据建立时间	250		100		ns
t <sub>h (SDA)</sub>	SDA数据保持时间	0		0	900	ns
$t_{r(SDA)}/t_{r(SCL)}$	SDA和SCL上升时间		1000	20		ns
$t_{f(SDA)}/t_{f(SCL)}$	SDA和SCL下降时间		300			ns
t <sub>h(STA)</sub>	开始条件保持时间	4. 0		0.6		us
t <sub>su(sta)</sub>	重复的开始条件建立时间	4. 7		0.6		us
t <sub>su(sto)</sub>	停止条件建立时间	4. 0		0.6		us
tw(STO:STA)	停止条件至开始条件的时间(总线空闲)	4. 7		1. 2		us
Сь	每条总线的容性负载		400		400	pF

## 3.3.16 SPI接口特性

## 图3-7 SPI主模式时序图

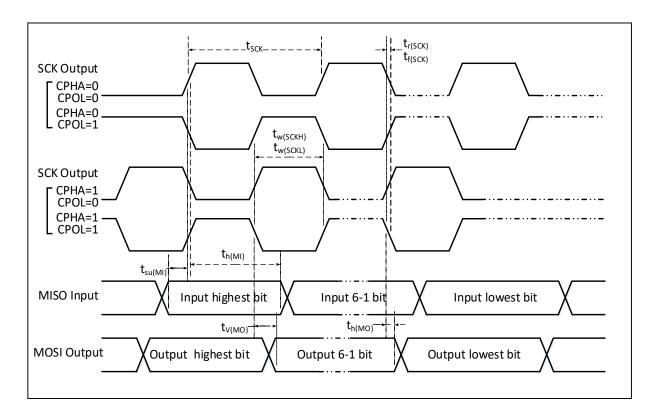
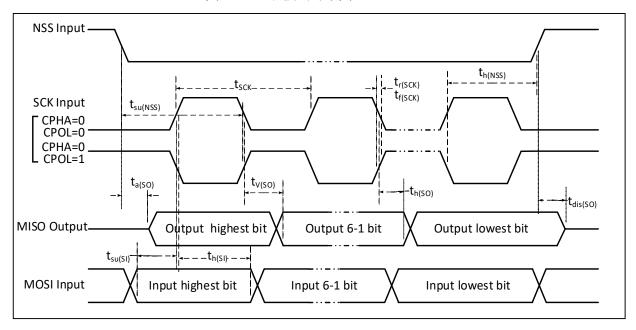
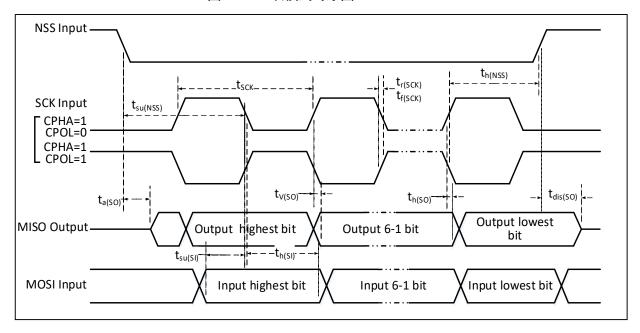


图3-8 SPI从模式时序图(CPHA=0)



## 图3-9 SPI从模式时序图(CPHA=1)



## 表3-32 SPI接口特性

符号	参数	条件		最小值	最大值	单位
c /ı	CD L 미국산바뉴도 호호	主模式			36	MHz
f <sub>sck</sub> /t <sub>sck</sub>	SPI时钟频率	从模式			36	MHz
$t_{r(SCK)}/t_{f(SCK)}$	SPI时钟上升和下降时间	负载电额	字: C = 30pF		8	ns
t <sub>su (NSS)</sub>	NSS建立时间	从模式		2*t <sub>HCLK</sub>		ns
t <sub>h (NSS)</sub>	NSS保持时间	从模式		2*t <sub>HCLK</sub>		ns
	COV言由亚和低由亚叶间	主模式,	f <sub>HCLK</sub> = 24MHz,预	70	0.7	
$t_{w(SCKH)}/t_{w(SCKL)}$	SCK高电平和低电平时间	分频系数	数=4	70	97	ns
t <sub>su(MI)</sub>		主模式	HSRXEN = 0	12		ns
USU(MI)	数据输入建立时间	土俣八	HSRXEN = 1	12-0. 5*t <sub>sck</sub>		
t <sub>su(si)</sub>		从模式		4		ns
_		→ 措 <del>士</del>	HSRXEN = 0	-4		ns
t <sub>h(MI)</sub>	数据输入保持时间	主模式	HSRXEN = 1	0. 5*t <sub>sck</sub> -4		
t <sub>h(SI)</sub>		从模式		4		ns
t <sub>a (S0)</sub>	数据输出访问时间	从模式,	$f_{HCLK} = 20MHz$	0	1*t <sub>HCLK</sub>	ns
t <sub>dis(SO)</sub>	数据输出禁止时间	从模式		0	10	ns
t <sub>V(S0)</sub>	粉块烧虫方沙叶间	从模式	(使能边沿之后)		15	ns
t <sub>v(MO)</sub>	数据输出有效时间	主模式(使能边沿之后)			5	ns
t <sub>h(S0)</sub>	** 据绘山/兄共叶词	从模式	(使能边沿之后)	8		ns
t <sub>h (MO)</sub>	数据输出保持时间	主模式	(使能边沿之后)	0		ns

## 3.3.17 模拟/数字转换器ADC特性

表3-33 12位ADC特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
$V_{DD33}$	供电电压		3. 1	3. 3	3. 5	٧
I <sub>DDADC</sub>	供电电流			1		mA
f <sub>ADC</sub>	ADC时钟频率				18	MHz
VAIN	转换电压范围		0		V <sub>DD33</sub>	٧
C <sub>ADC</sub>	内部采样和保持电容			6		pF
fs	采样速率	$f_{ADC} = 18MHz$	250		1000	kHz
l s	木件坯 <del>竿</del> 		1/72		1/18	$f_{ADC}$
_	采样时间	$f_{ADC} = 18MHz$	0. 31		3. 31	us
t <sub>s</sub>	本作り回		5. 5		59. 5	1/f <sub>ADC</sub>
t <sub>STAB</sub>	上电时间			7		us
+	总的转换时间	$f_{ADC} = 18MHz$	1		4	us
t <sub>conv</sub>	(包括采样时间)		18		72	1/f <sub>ADC</sub>

注: 以上均为设计参数保证。

公式:最大RAIN

$$R_{AIN} < \frac{T_S}{f_{ADC} \times C_{ADC} \times \ln 2^{N+2}} - R_{ADC}$$

上述公式用于决定最大的外部阻抗, 使得误差可以小于1/4 LSB。其中N = 12(表示12位分辨率)。

表3-34 fabc = 18MHz时的最大Rain

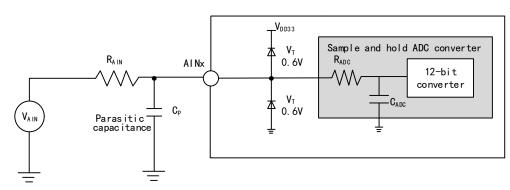
T <sub>s</sub> (周期)	ts(us)	最大R <sub>AIN</sub> (kΩ)
5. 5	0. 31	3. 8
11.5	0. 64	9. 4
23. 5	1. 31	21
59. 5	3. 31	55

表3-35 ADC误差

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
ET	数据总偏差			±3	±8	
E0	失调误差	$f_{ADC} = 18MHz,$		±1	±3	
EG	增益误差	$R_{AIN} < 4k \Omega$ ,		±2	±4	LSB
ED	微分非线性误差	$V_{DD33} = 3.3V$		±3	±7	
EL	积分非线性误差			±3	±7	

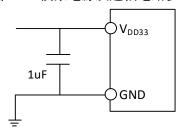
注: 以上均为设计参数保证。

## 图3-10 ADC典型连接图



C。表示PCB与焊盘上的寄生电容(大约5pF),可能与焊盘和PCB布局质量有关。较大的C。数值将降低转换精度,解决办法是降低fac值。

图3-11 模拟电源及退耦电路参考



## 3.3.18 运算放大器OPA特性

表3-36-1 OPA1特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
$V_{DD33}$	供电电压		3. 1	3. 3	3. 5	٧
I DDQII	供电电流			270		uA
V <sub>CMIR</sub>	共模输入电压				V <sub>DD33</sub> -1.5	٧
VIOFFSET	输入失调电压			2	6	mV
Av <sup>(1)</sup>	开环增益			90		dB
		V0∈ (0. 3V, V <sub>DD33</sub> -0. 3V)		600		kHz
BW <sup>(1)</sup>	0PA1运算放大器带宽	V0∈ (0. 2V, V <sub>DD33</sub> -0. 2V)		500		
		V0∈ (0. 1V, V <sub>DD33</sub> -0. 1V)		400		
PGA <sub>GAIN</sub> (1)	PGA增益误差	Gain = 20	-1		1	%
FUAGAIN	PGA增益误差	Gain = 40	-1		1	/0
R <sub>BIAS</sub>	在QIII模式下的偏置电阻			90		kΩ

注: 1. 设计参数保证。

表3-36-2 OPA2特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V <sub>DD33</sub>	供电电压		3. 1	3. 3	3. 5	٧
I DDQII	供电电流			270		uA
V <sub>CMIR</sub>	共模输入电压				V <sub>DD33</sub> -1.5	٧
V <sub>IOFFSET</sub>	输入失调电压			2	6	mV
Av <sup>(1)</sup>	开环增益			90		dB

		V0 ∈ (0. 3V, V <sub>DD33</sub> -0. 3V)		600		
BW <sup>(1)</sup>	0PA2运算放大器带宽	V0∈ (0. 2V, V <sub>DD33</sub> -0. 2V)		500		kHz
	PGA增益误差	V0∈ (0. 1V, V <sub>DD33</sub> -0. 1V)		400		
		Gain = 5	-1		1	
PGA <sub>GAIN</sub> (1)		Gain = 10	-1		1	- %
PGAGAIN		Gain = 20	-1		1	
		Gain = 40	-1		1	
R <sub>BIAS</sub>	在QII2模式下的偏置电阻			90		kΩ

注: 1. 设计参数保证。

## 表3-36-3 OPA3和OPA4特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V <sub>DD33</sub>	供电电压		3. 1	3. 3	3.5	٧
I DDISP	供电电流			420		uA
V <sub>CMIR</sub>	共模输入电压				V <sub>DD33</sub> -1.5	٧
VIOFFSET	输入失调电压			3	8	mV
<b>Av</b> <sup>(1)</sup>	开环增益			110		dB
G <sub>BW</sub> <sup>(1)</sup>	单位增益带宽			20		MHz
$P_{M}^{(1)}$	相位裕度			75		o
		Gain = 4	-1.3		1. 3	
	内部同相PGA增益误差	Gain = 8	-1.3		1. 3	%
		Gain = 16	-1.3		1. 3	
		Gain = 55	-1.6		1.6	
		Gain = 4	-1.3		1. 3	
PGA <sub>GAIN</sub> (1)	差分输入PGA增益误差	Gain = 8	-1.3		1. 3	%
FUAGAIN	(差分输入端串接100Ω电阻)	Gain = 16	-1.3		1. 3	/0
		Gain = 55	-1.6		1.6	
		Gain = 4	-0. 3		2. 3	
	差分输入PGA增益误差	Gain = 8	-0. 3		2. 3	%
	(差分输入端直连低阻信号源)	Gain = 16	-0. 3		2. 3	/0
		Gain = 55	-0.6		2. 6	
<b>S</b> <sub>R</sub> <sup>(1)</sup>	摆率		10	20	30	V/us
V <sub>OHSAT</sub> (1)	高饱和电压	无负载	V <sub>DD33</sub> -300			mV
Volsat (1)	低饱和电压	无负载			300	mV
t <sub>WAKEUP</sub> (1)	关闭到唤醒时间, 0.1%				1	us
eN <sup>(1)</sup>	输出噪声密度	1kHz		200		nV/
en	刑山怀尸名戊	10kHz		80		sqrt(Hz)

# 注: 1. 设计参数保证。

# 3.3.19 CMP特性

表3-37-1 CMP1特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
$V_{ extsf{DD33}}$	供电电压		3. 1	3. 3	3. 5	٧
V <sub>CMIR</sub>	共模输入电压			1. 2	V <sub>DD33</sub> -1.5	٧

V <sub>IOFFSET</sub> (1)	输入失调电压		3. 5	mV
DDOPAMP	消耗电流		35	uA
l v	迟滞电压	QII1_HYPSEL = 0	100	mV
$V_{hys}$		QII1_HYPSEL = 1	200	mV
t <sub>D</sub> <sup>(1)</sup>	比较器延时, V <sub>INP</sub> 从(V <sub>INN</sub> -10mV)到 (V <sub>INN</sub> +10mV)变化	V <sub>INN</sub> = 1.2V	40	ns

注: 1. 设计参数保证。

# 表3-37-2 CMP2特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
$V_{DD33}$	供电电压		3. 1	3. 3	3. 5	٧
V <sub>CMIR</sub>	共模输入电压		0		V <sub>DD33</sub>	٧
		共模输入, 0.6V < V <sub>CMIR</sub> <v<sub>DD33-0.6V</v<sub>		2	6	
V <sub>IOFFSET</sub> (1)	输入失调电压	共模输入, V <sub>CMIR</sub> < 0.6V或 V <sub>CMIR</sub> > V <sub>DD33</sub> -0.6V		3. 5	11	mV
I DDOPAMP	消耗电流			55		uA
V <sub>hys</sub>	迟滞电压	QII2_HYPSEL[2:0] = 000 QII2_HYPSEL[2:0] = 001 QII2_HYPSEL[2:0] = 010 QII2_HYPSEL[2:0] = 011 QII2_HYPSEL[2:0] = 100 QII2_HYPSEL[2:0] = 101 QII2_HYPSEL[2:0] = 110 QII2_HYPSEL[2:0] = 111		0 5 10 20 40 50 60		mV
t <sub>D</sub> <sup>(1)</sup>	比较器延时, V <sub>INP</sub> 从(V <sub>INN</sub> -100mV)到 (V <sub>INN</sub> +100mV)变化	V <sub>INN</sub> = 1.2V		30		ns
DACINL	CMP2内部DAC积分非线 性误差, 0.1V≤DAC_OUT≤3.1V, step = 200mV	V <sub>DD33</sub> = 3.3V			30	mV

注: 1. 设计参数保证。

# 表3-37-3 CMP3电压比较器特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
$V_{DD33}$	供电电压		3. 1	3. 3	3. 5	٧
V <sub>CMIR</sub>	共模输入电压		0		V <sub>DD33</sub>	V
V <sub>IOFFSET</sub> (1)	输入失调电压	共模输入, 0.6V < V <sub>CMIR</sub> < V <sub>DD33</sub> -0.6V		2	6	\/
		共模输入, V <sub>CMIR</sub> < 0.6V或		3. 5	11	mV

		$V_{CMIR} > V_{DD33}-0.6V$			
I DDOPAMP	消耗电流		50		uA
		HYS[1:0] = 00	0		mV
$V_{hys}$		HYS[1:0] = 01	10		mV
<b>V</b> hys	近滞电压 	HYS[1:0] = 10	20		mV
		HYS[1:0] = 11	40		mV
	比较器延时,				
<b>t</b> <sub>D</sub> <sup>(1)</sup>	V <sub>INP</sub> 从(V <sub>INN</sub> -100mV)到	$0 \leqslant V_{INN} \leqslant V_{DD33}$	17	50	ns
	(V <sub>INN</sub> +100mV)变化				
	内部DAC积分非线性误				
DACINL	差,	$V_{DD33} = 3.3V$		50	mV
DACTNL	0.1V≤DAC_OUT≤3.1V,	V DD33 - 3. 3 V		30	IIIV
	step = 200mV				

注: 1. 设计参数保证。

## 3.3.20 ISINK模块电流特性

## 表3-38 10位ISINK模块电流特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V <sub>DD33</sub>	供电电压		3. 1	3. 3	3. 5	٧
I STEP (2)	单位电流值(1*LSB)			0. 244		uA
I <sub>sw</sub>	电流输出范围	V <sub>PAD</sub> > 0.6V	0		1023*LSB	uA
I 180 (1)	电流绝对值误差		-2*LSB		2*LSB	uA
I <sub>INL</sub> (1)	电流积分非线性误差	校准后			±4	LSB
I DNL (1)	电流微分非线性误差				±2	LSB
(1)	ISINK电流温度特性	T <sub>A</sub> = 0∼55°C, 输入值0×200	-3		+2	LSB
I TC		T <sub>A</sub> = -40~105℃, 输入值0x200	-6		+5	LSB
t <sub>SETTLING</sub> (1)	建立时间(全范围:输入代码从最小值转变为最大值,ISNK_OUT达到其终值的±1*LSB)			1	3	us
V <sub>UPDATE</sub> (1)	当输入代码为较小变化时(从数值 i 到 i+1*LSB ), 得 到 正 确 ISNK_OUT的最大频率。				1	MS/s
twakeup (1)	从关闭状态唤醒的时间			2	4	us

## 注: 1. 设计参数保证。

2. 如果控制外部DC-DC,上电阻可取值82K,电压调节步距为20mV。

## 3. 3. 21 ISOURCE模块电流特性

## 表3-39 ISOURCE模块电流特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
$V_{DD33}$	供电电压		3. 1	3. 3	3. 5	٧
l sw <sup>(1)</sup>	电流输出范围	ISRCx_SEL = 0 (x = 1, 2), $V_{PAD} < V_{DD33}$ -0.6V	6	8	10	uA

		ISRCx_SEL = 1 (x = 1, 2), $V_{PAD} < V_{DD33}$ -0.6V	26	32	38	uA
I <sub>TC</sub> (1)	ISOURCE电流温度特性	$T_A = -40 \sim 105^{\circ}C$	-2		+2	%

注: 1. 设计参数保证。

# 第4章 封装及订货信息

# 芯片封装

封装形式	塑体尺寸	引脚节距		封装说明	订货型号	
QFN48X7_A	7*7mm	0. 5mm	19.7mil	四边无引线48脚	CH32M030C8U3	
LQFP48	7*7mm	0. 5mm	19.7mil	标准LQFP48贴片	CH32M030C8T7	
QFN48	5*5mm	0. 35mm	13.8mil	四边无引线48脚	CH32M030C8U7	
QFN32	4*4mm	0. 4mm	15. 7mil	四边无引线32脚	CH32M030K8U7	
QS0P28	3. 9*9. 9mm	0. 635mm	25. Omil	1/4尺寸28脚贴片	CH32M030G8R7	

说明:尺寸标注的单位是mm(毫米),引脚中心间距总是标称值,没有误差,除此之外的尺寸误差不大于±0.2mm或者±10%两者中的较大值。

图4-1 LQFP48封装

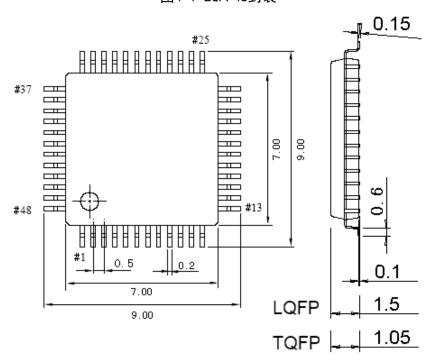
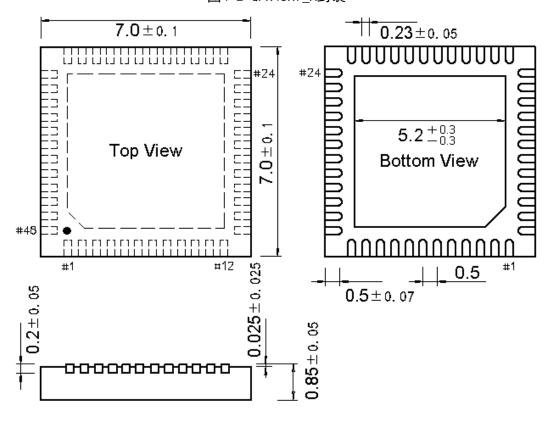


图4-2 QFN48X7\_A封装



#### 图4-3 QFN48封装

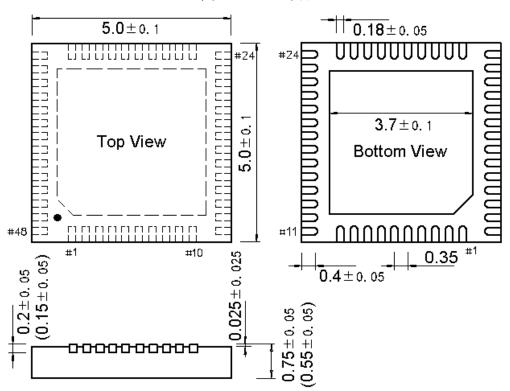
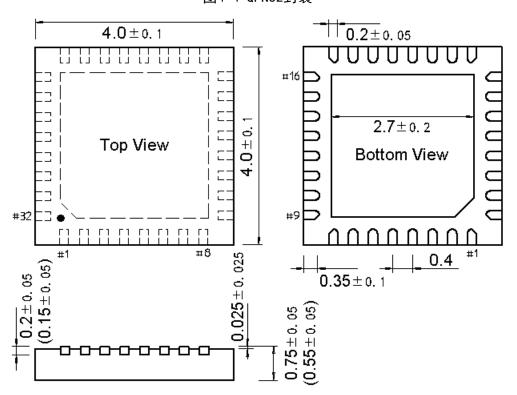
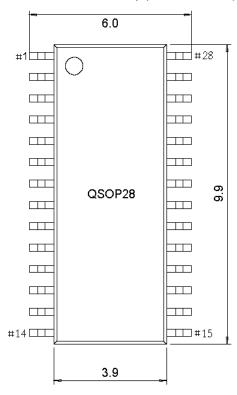
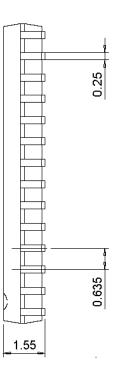


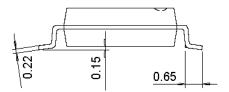
图4-4 QFN32封装



# 图4-5 QSOP28封装







# 系列产品命名规则

303

R

F = Arm内核, 通用MCU

V = 青稞RISC-V内核, 通用MCU

L = 青稞RISC-V内核, 低功耗MCU

X = 青稞RISC-V内核, 专用或特殊外设MCU

M = 青稞RISC-V内核,内置预驱的电机MCU

产品类型(\*)+产品子系列(\*\*)

产品类型	产品子系列
0 = 青稞V2/V4内核,	02 = 16K闪存超值通用型
超值版,主频<=48M	03 = 16K闪存基础通用型, 0PA
	05 = 32K闪存增强通用型, OPA、双串口
	06 = 64K闪存多能通用型,0PA、双串口、TKey
	07 = 基础电机应用型,OPA+CMP
	35 = 连接型, USB、USB PD/Type-C
	33 = 连接型, USB
	30 = 电机应用型, OPA+CMP、USB、PD/Type-C
1 = M3/青稞V3/V4内核,	03 = 连接型, USB
基本版,主频<=96M	05 = 连接型, USB HS、SDIO、CAN
2 = M3/青稞V4非浮点内核,	07 = 互联型, USB HS、CAN、以太网、SDIO、FSMC
增强版,主频<=144M	08 = 无线型, BLE5.x、CAN、USB、以太网
3 = 青稞V4F浮点内核,	17 = 互联型, USB HS、CAN、以太网(内置PHY)、
增强版,主频<=144M	SDIO, FSMC

#### 引脚数目

 J = 8脚
 D = 12脚
 A = 16脚
 F = 20脚
 E = 24脚

 G = 28脚
 K = 32脚
 T = 36脚
 C = 48脚
 R = 64脚

W = 68脚 V = 100脚 Z = 144脚

#### 闪存存储容量

4 = 16K闪存存储器6 = 32K闪存存储器7 = 48K闪存存储器8 = 64K闪存存储器B = 128K闪存存储器C = 256K闪存存储器

T = LQFP U = QFN R = QSOP P = TSSOP M = SOP

#### 温度范围

封装

6 = -40°C~85°C (工业级) 7 = -40°C~105°C (扩展工业级、汽车2级)

3 = -40°C~125°C (汽车1级) D = -40°C~150°C (汽车0级)